

# **Проводники и диэлектрики в электрическом поле**

# Микро- и макрополя

Заряды (+ –)

- **связанные** – входят в состав атомов (молекул), под действием эл. поля они могут смещаться из положения равновесия, но не могут покинуть молекулу (атом);
- **сторонние** или **свободные**
  - не входят в состав атомов (молекул), но находятся в пределах диэлектрика,
  - заряды вне диэлектрика

## Микро- и макрополя

**Микроскопическое** или **истинное** поле – суперпозиция (результат) поля сторонних зарядов ( $\vec{E}_{стор}$ ) и поля связанных зарядов ( $\vec{E}_{связ}$ ):

$$\vec{E}_{микро} = \vec{E}_{стор} + \vec{E}_{связ}$$

$$\vec{E}_{макро} = \langle \vec{E}_{микро} \rangle = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

# Проводники и диэлектрики

- **Проводники** – это вещества, в которых свободные заряды перемещаются под действием электрического поля.
- **Металлы** (свободные заряды: электроны) – проводники **первого рода**
- **Электролиты и ионизированный газ** (свободные заряды: положительные и отрицательные ионы) – проводники **второго рода**, в них при протекании тока есть перенос вещества.

## Проводники и диэлектрики

- **Диэлектрики (изоляторы)** – это вещества, не способные проводить электрический ток.

Удельное сопротивление диэлектриков в  $10^{15} \div 10^{20}$  раз больше, чем у проводников.

# Проводники и диэлектрики

Все положительные заряды молекул (атомов) можно заменить одним суммарным зарядом  $+q$ , помещенным в некоторую точку, называемую **центром тяжести положительных зарядов**,

её радиус-вектор:

$$\vec{r}_+ = \frac{\sum q_{i+} \vec{r}_{i+}}{q_+}$$

**Центр тяжести отрицательных зарядов**

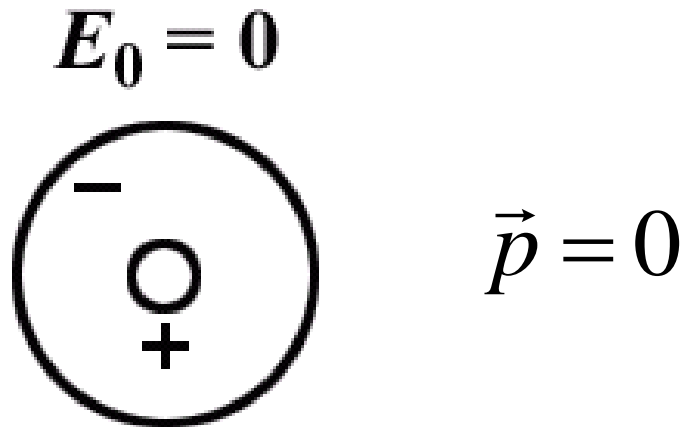
$$\vec{r}_- = \frac{\sum q_{i-} \vec{r}_{i-}}{q_-}$$

# Проводники и диэлектрики

- Молекулу в первом приближении можно рассматривать как диполь (дипольный момент  $\vec{p} = |q|\vec{l}$  )
- Диэлектрики в зависимости от строения их молекул и внутренней структуры можно разделить на
  - 1) *Неполярные диэлектрики*
  - 2) *Полярные диэлектрики*
  - 3) *Ионные диэлектрики*

# Проводники и диэлектрики

- 1) *Неполярные диэлектрики* ( $\text{H}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}_2$ ...) – молекула имеет симметричное строение





# Проводники и диэлектрики

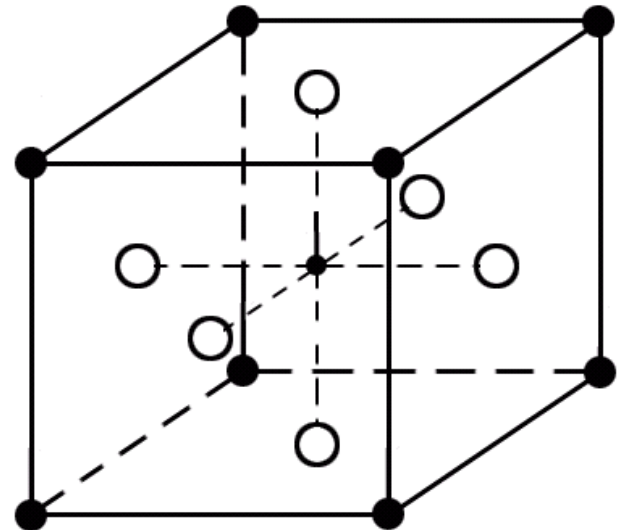
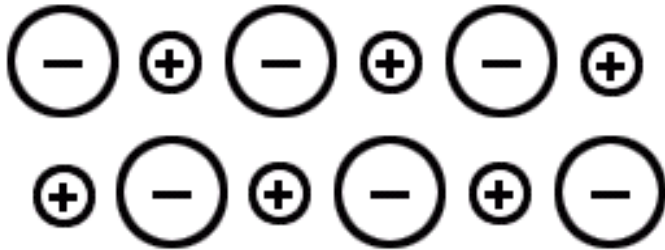
2) **Полярные диэлектрики** ( $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{CO}$  ...) – молекула имеет не симметричное строение, то есть центры тяжести + и - зарядов в отсутствии внешнего электрического поля не совпадают, следовательно, молекула обладает дипольным моментом.

При отсутствии внешнего электрического поля  $\sum p_i = 0$



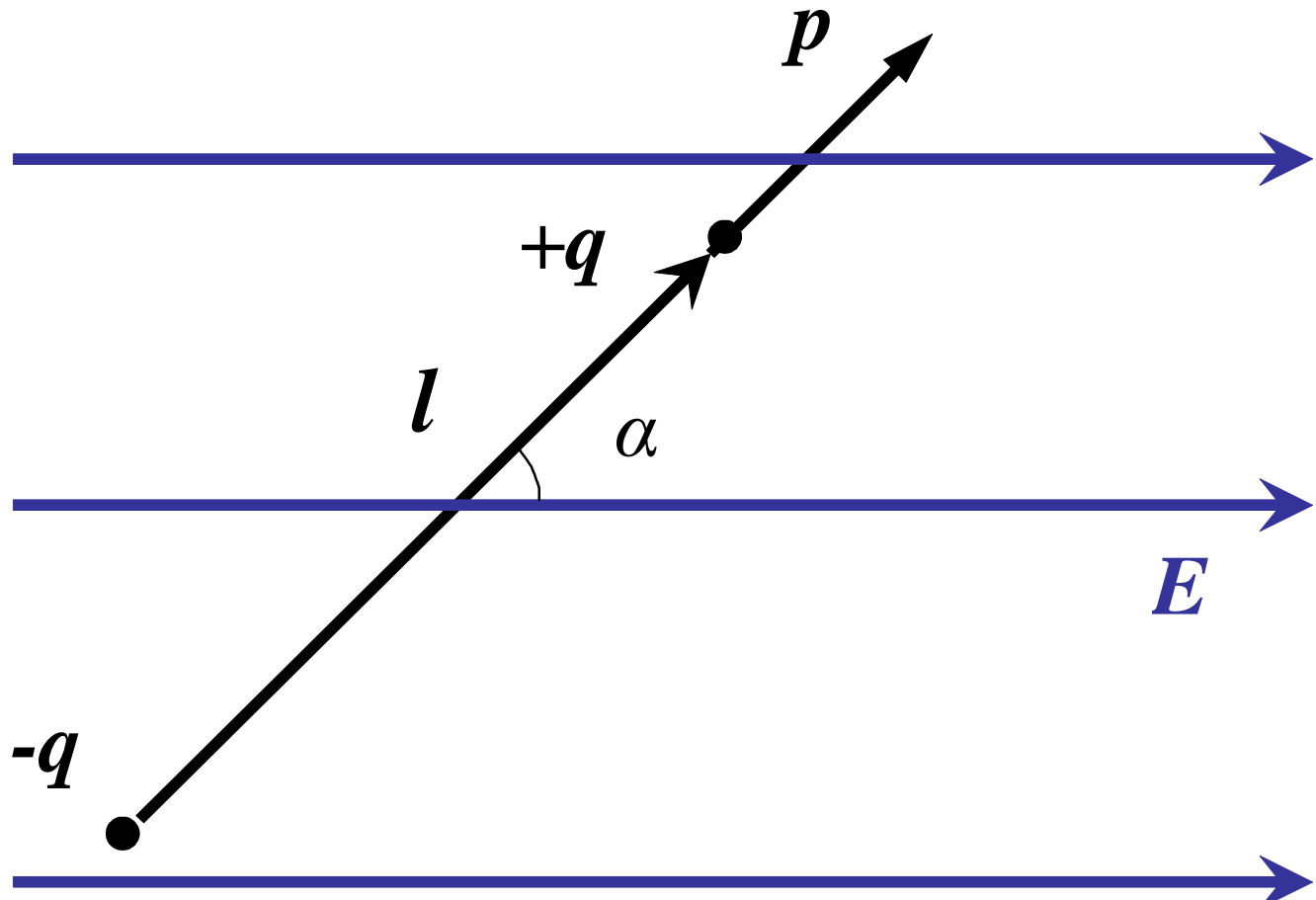
## Проводники и диэлектрики

- 3) *Ионные диэлектрики* (NaCl, KCl, KBr) – молекулы имеют ионное строение, а диэлектрик представляет собой ионную кристаллическую решетку с чередованием ионов разных знаков.



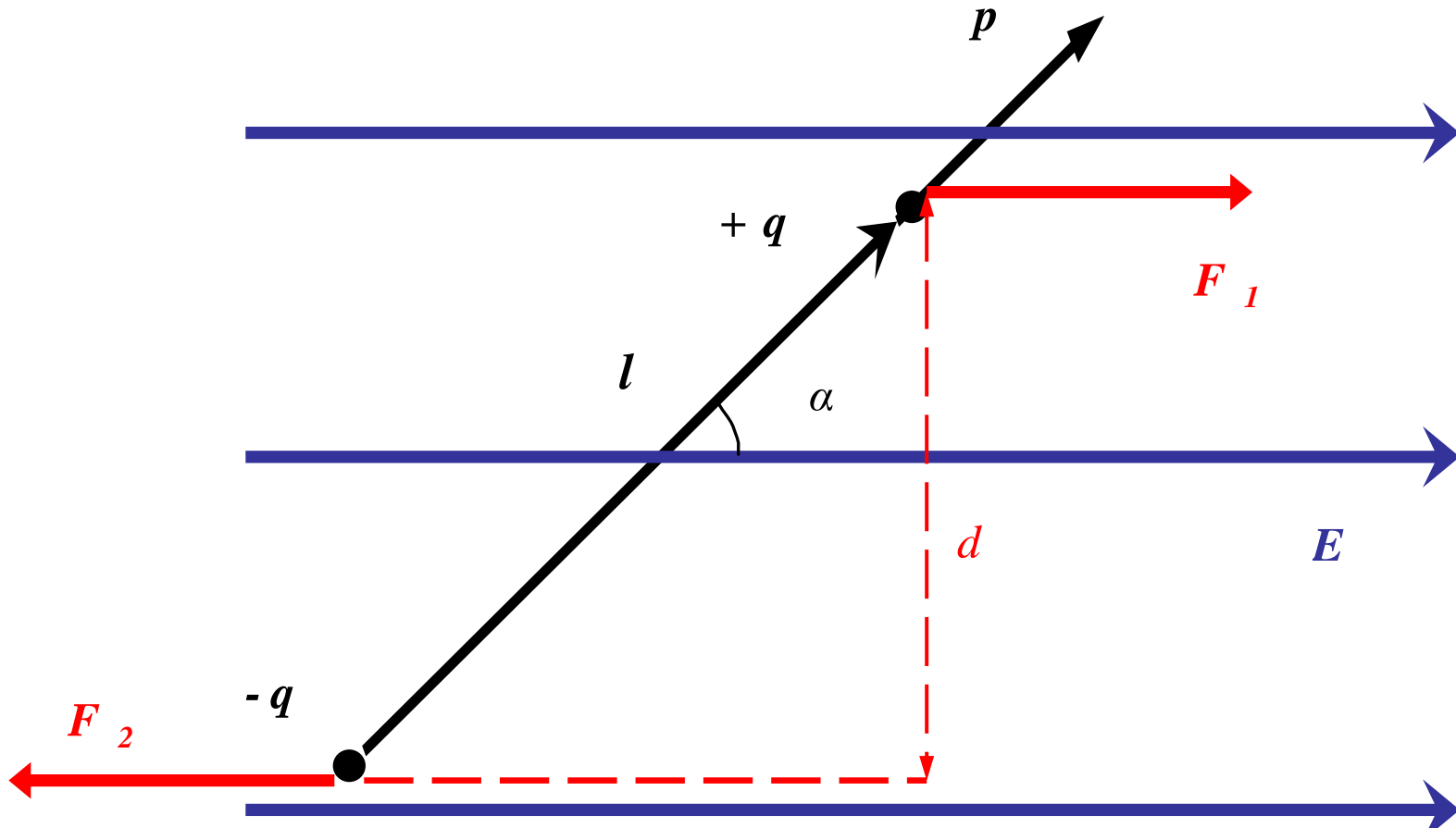
## Диполь в электрическом поле

- Диполь находится в **однородном** электрическом поле ( $E = const$ ).

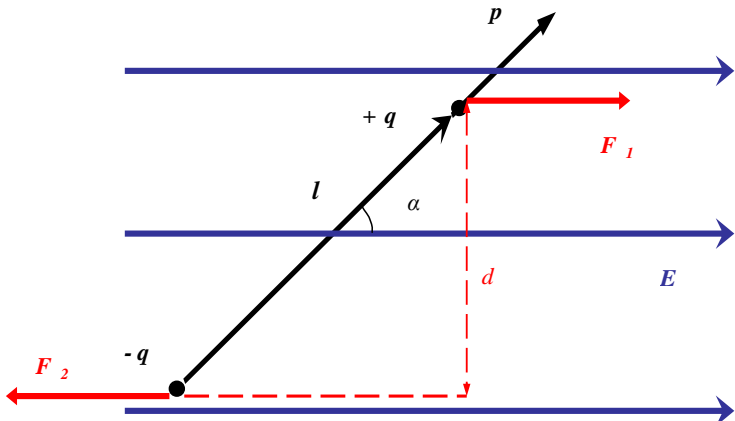


## Диполь в электрическом поле

- Диполь находится в **однородном** электрическом поле ( $E = const$ ).



# Диполь в электрическом поле



Вращающий момент

$$M = Fd$$

$$M = Fl \sin \alpha$$

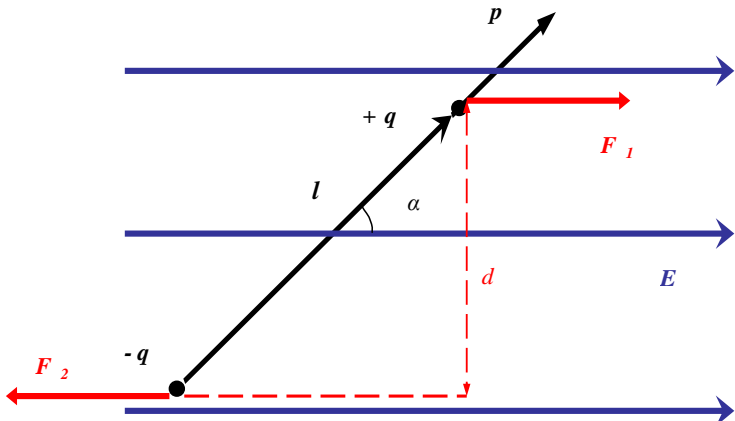
$$M = qEl \sin \alpha = qlE \sin \alpha,$$

$$\vec{p}_l = ql.$$

$$\vec{M} = [\vec{p}_l, \vec{E}]$$

Вращающий момент  $\mathbf{M}$  стремится повернуть диполь и установить его так, чтобы  $\vec{p}_l \uparrow \uparrow \vec{E}$

## Диполь в электрическом поле



Работа против сил,  
действующих на диполь

$$dA = Md\alpha = pE \sin \alpha d\alpha$$

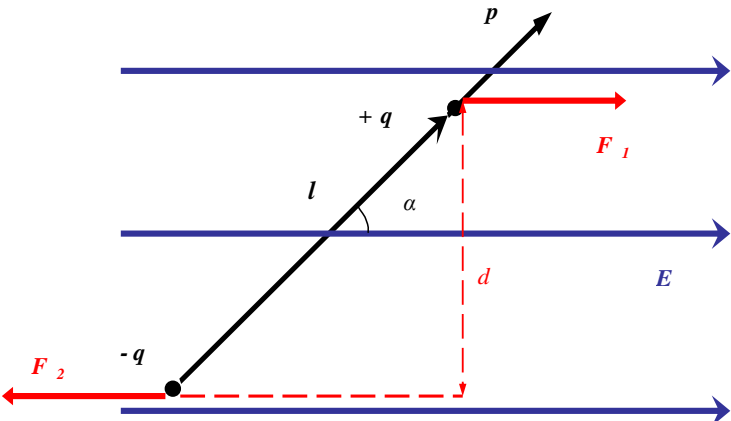
Работа идет на увеличение потенциальной энергии  $W$ ,  
которой обладает диполь в электрическом поле:

$$dW = pE \sin \alpha d\alpha$$

$$W = -pE \cos \alpha + const$$

$$W = -pE \cos \alpha = -(\vec{p}\vec{E})$$

## Диполь в электрическом поле



- Поле **неоднородное** ( $E \neq const$ ), то помимо вращающего момента на диполь действует сила

$$F = F_2 - F_1 = q(E_2 - E_1) = q \frac{\partial E}{\partial l} l = p_l \frac{\partial E}{\partial l}$$

$$\vec{F} = p_l \frac{\partial \vec{E}}{\partial l}$$

Под действием этой силы диполь стремится переместиться в область наибольшей напряженности  $E$  электрического поля.

$$\vec{F} = \overline{grad}(\vec{p}_l \cdot \vec{E})$$

# Поляризация диэлектриков

**Поляризация диэлектриков** – процесс ориентации диполей или появления под действием внешнего электрического поля  $E_0$  ориентированных по полю диполей.

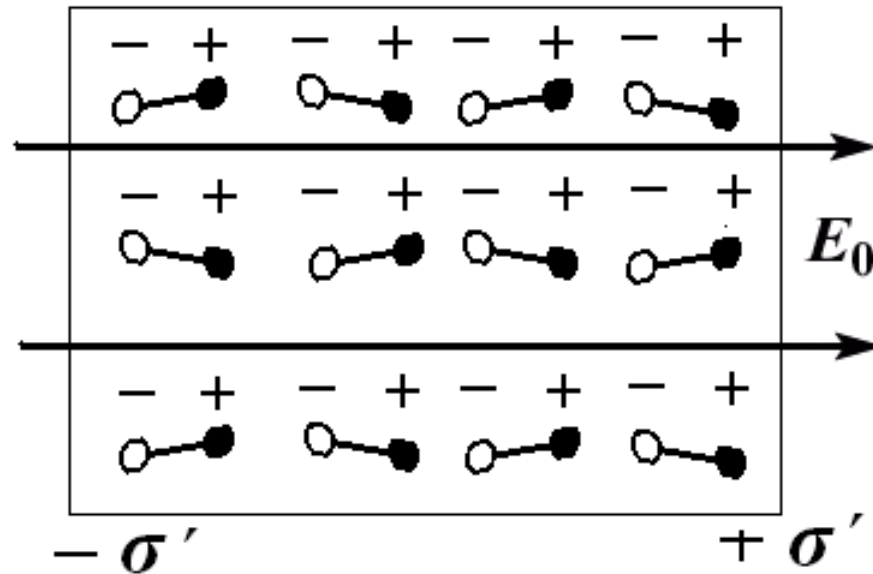
В зависимости от типа диэлектриков будет различаться вид поляризации.



# Поляризация диэлектриков

полярные диэлектрики

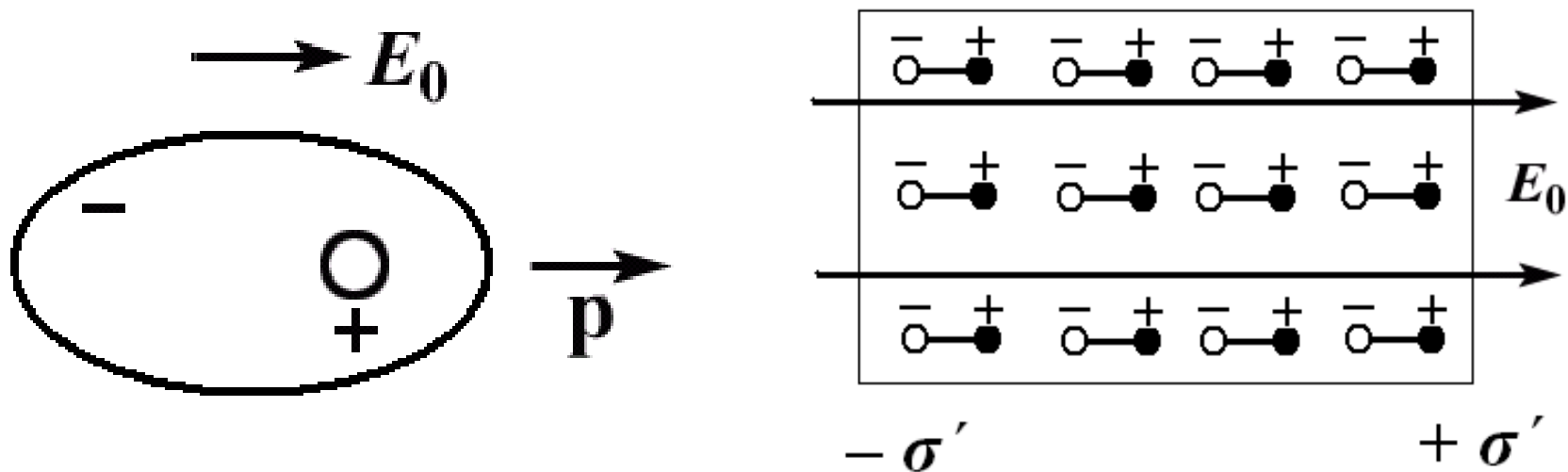
*ориентационная (дипольная)* поляризация



# Поляризация диэлектриков

## Неполярные диэлектрики

*электронная (деформационная) поляризация*



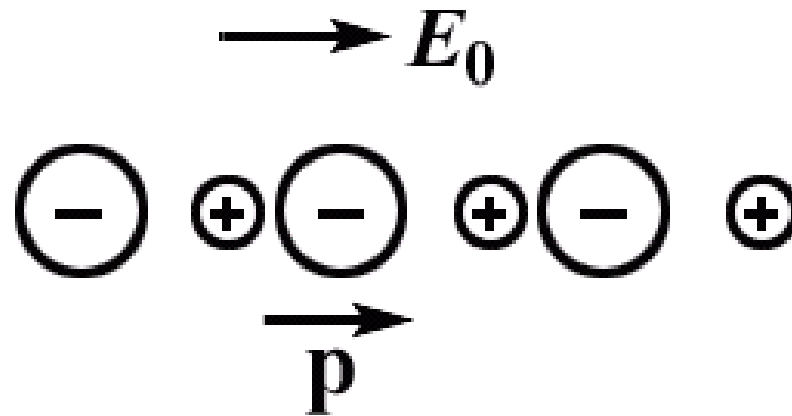
$$\vec{p} = \alpha \epsilon_0 \vec{E},$$

$\alpha$  — поляризуемость молекулы

# Поляризация диэлектриков

## ионные диэлектрики

*ионная* поляризация



## Поляризованность (вектор поляризации)

- Дипольный момент диэлектрика

$$\vec{p}_V = \sum_i \vec{p}_{li}$$

$p_{li}$  — дипольный момент одной молекулы.

**Поляризованность** диэлектрика — дипольный момент единичного объема:

$$\vec{P} = \frac{\vec{p}_V}{V} = \frac{\sum_i \vec{p}_{li}}{V} \quad [(\text{Кл} \cdot \text{м})/\text{м}^3 = \text{Кл}/\text{м}^2].$$

## Поляризованность (вектор поляризации)

- Для изотропного диэлектрика с неполярными молекулами:

$$\vec{P} = \vec{p}_l \cdot n = \alpha \varepsilon_0 n \vec{E} = \chi \varepsilon_0 \vec{E},$$

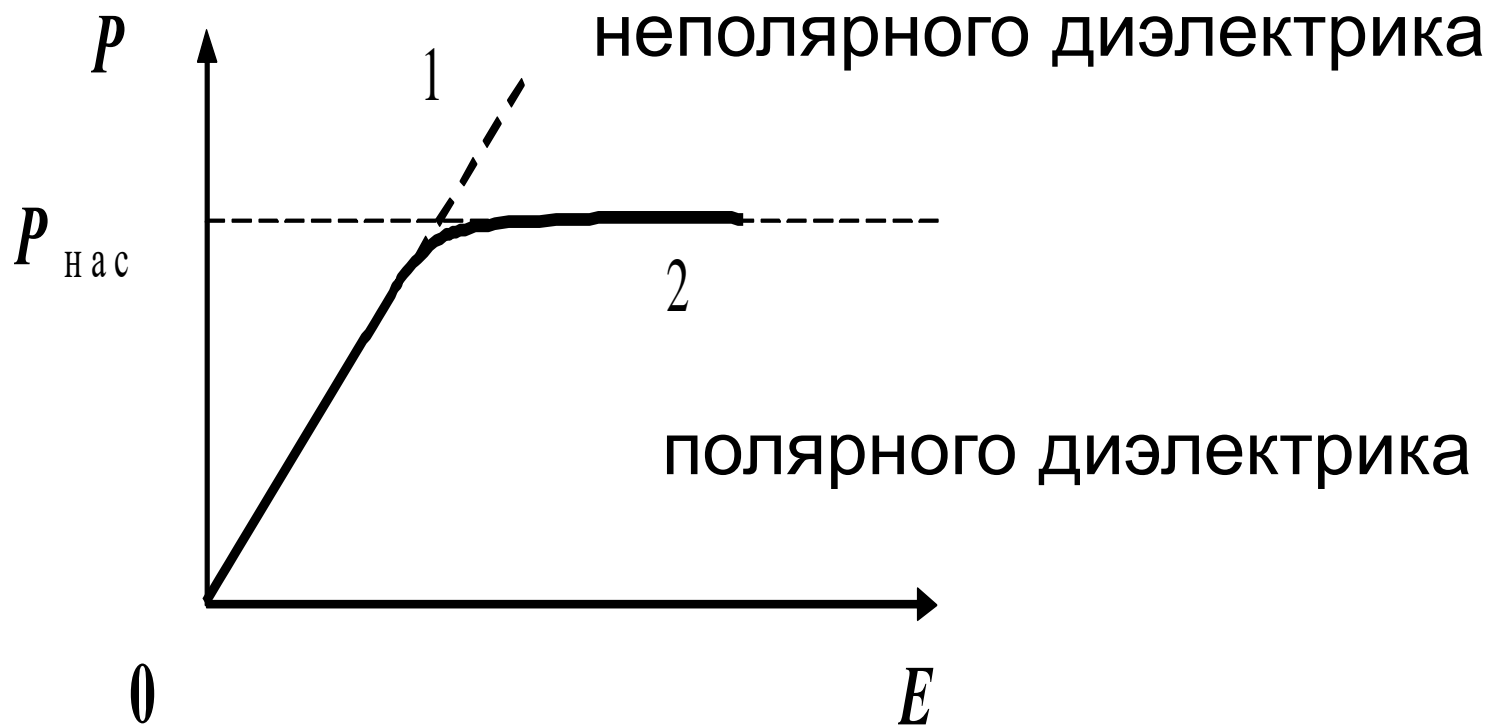
где  $n$  – концентрация молекул

$$\chi = \alpha \cdot n$$

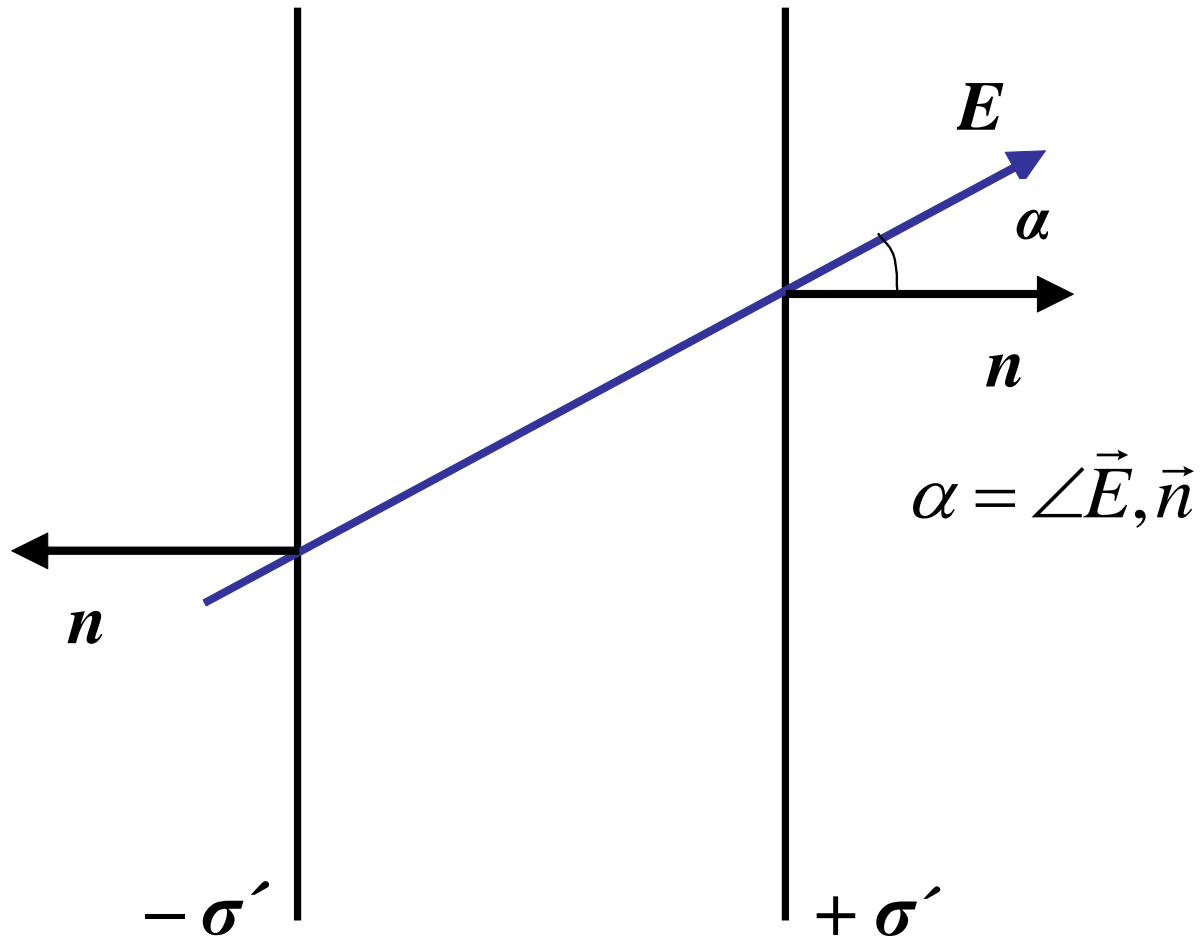
**диэлектрической  
восприимчивостью**

## Поляризованность (вектор поляризации)

$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E},$$

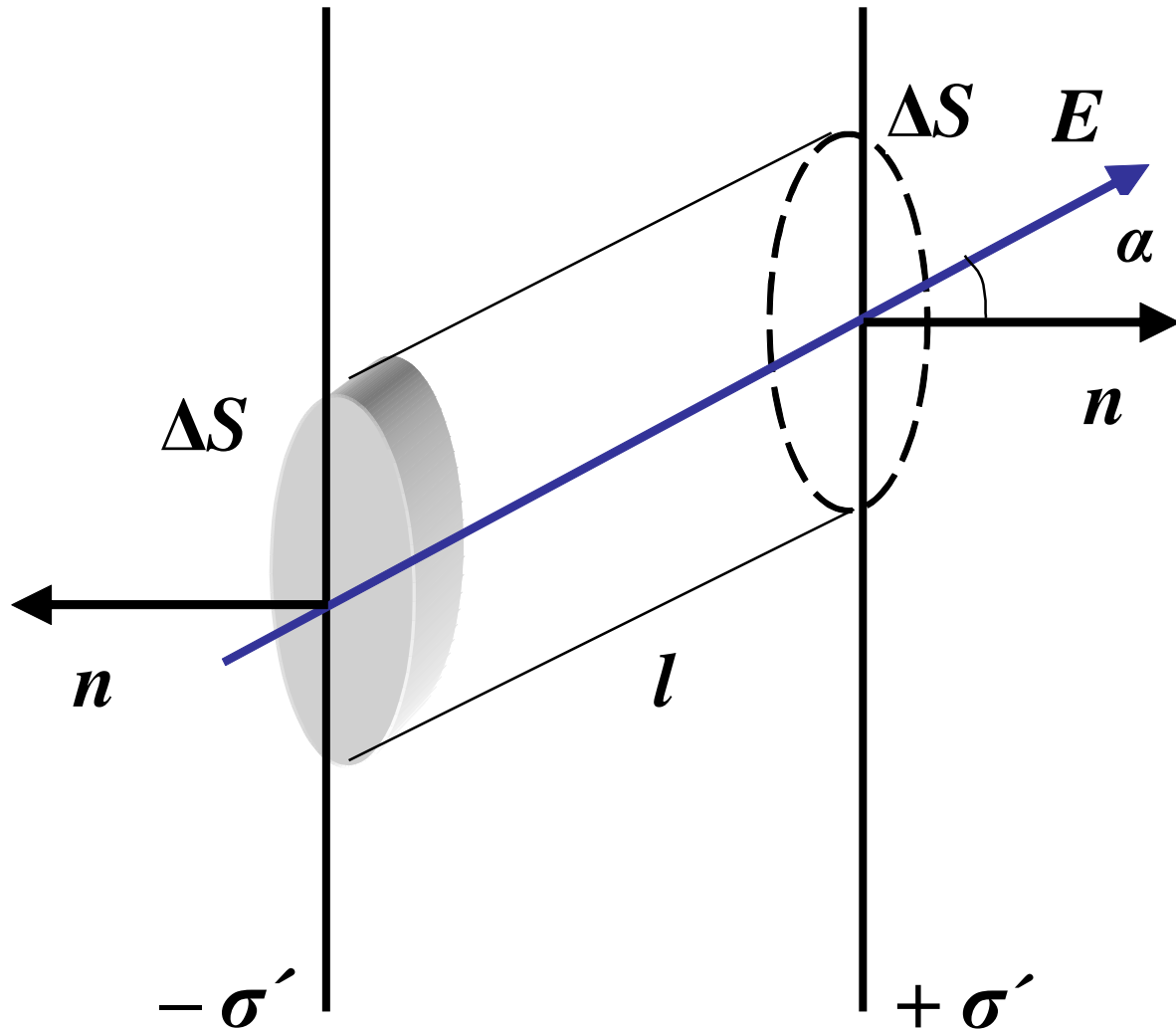


## Связь между вектором $P$ и $\sigma'$



Однородная диэлектрическая пластинка

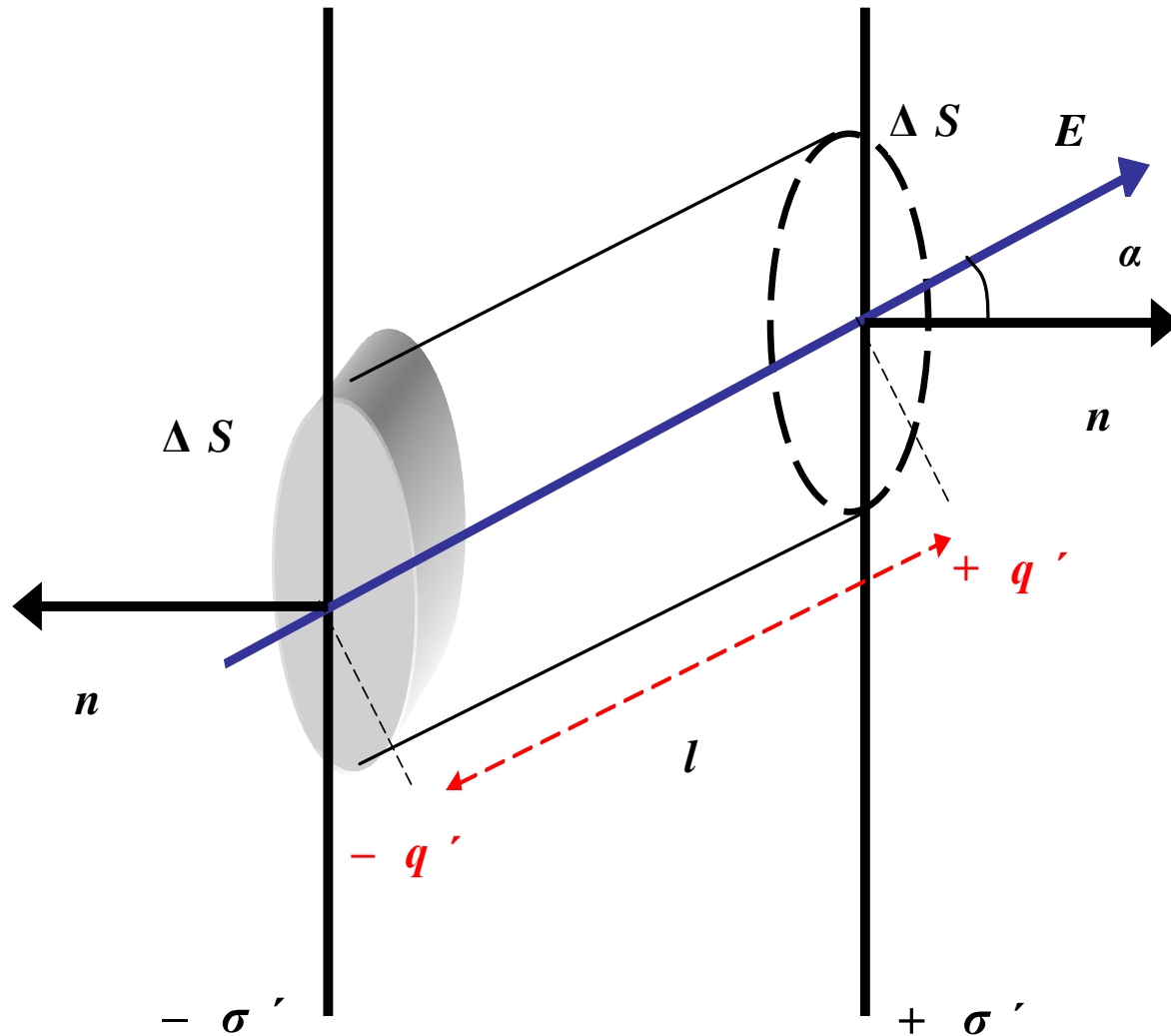
## Связь между вектором $P$ и $\sigma$



Однородная диэлектрическая пластинка



## Связь между вектором $P$ и $\sigma$



Однородная диэлектрическая пластинка

## Связь между вектором $P$ и $\sigma$

$$\Delta V = \Delta S_{\perp} \cdot l = \Delta S \cdot l \cos \alpha$$

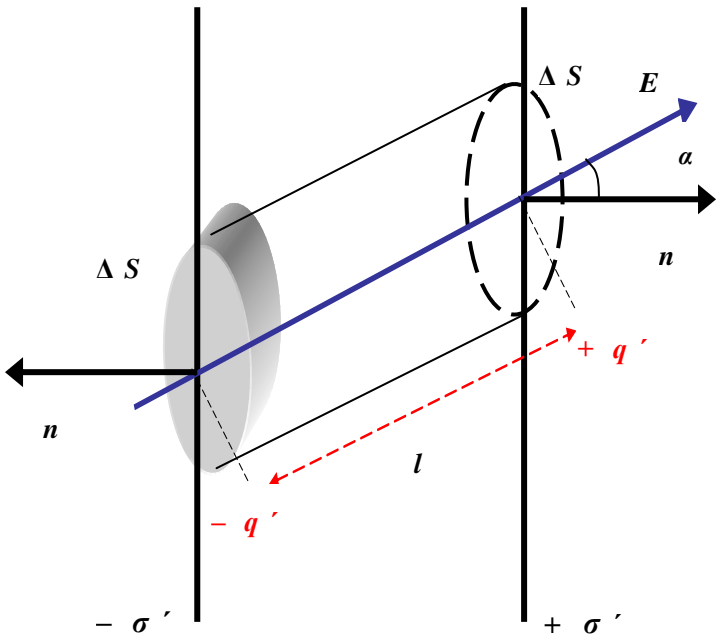
$$p_l = q \cdot l = \sigma' \cdot \Delta S \cdot l$$

$$P = \frac{p_l}{\Delta V}$$

$$p_l = P \cdot \Delta V = P \cdot \Delta S \cdot l \cos \alpha$$

$$P \cos \alpha = \sigma' \quad \Rightarrow \quad P_n = \sigma'$$

$$P_n = \sigma' = \chi \varepsilon_0 E$$



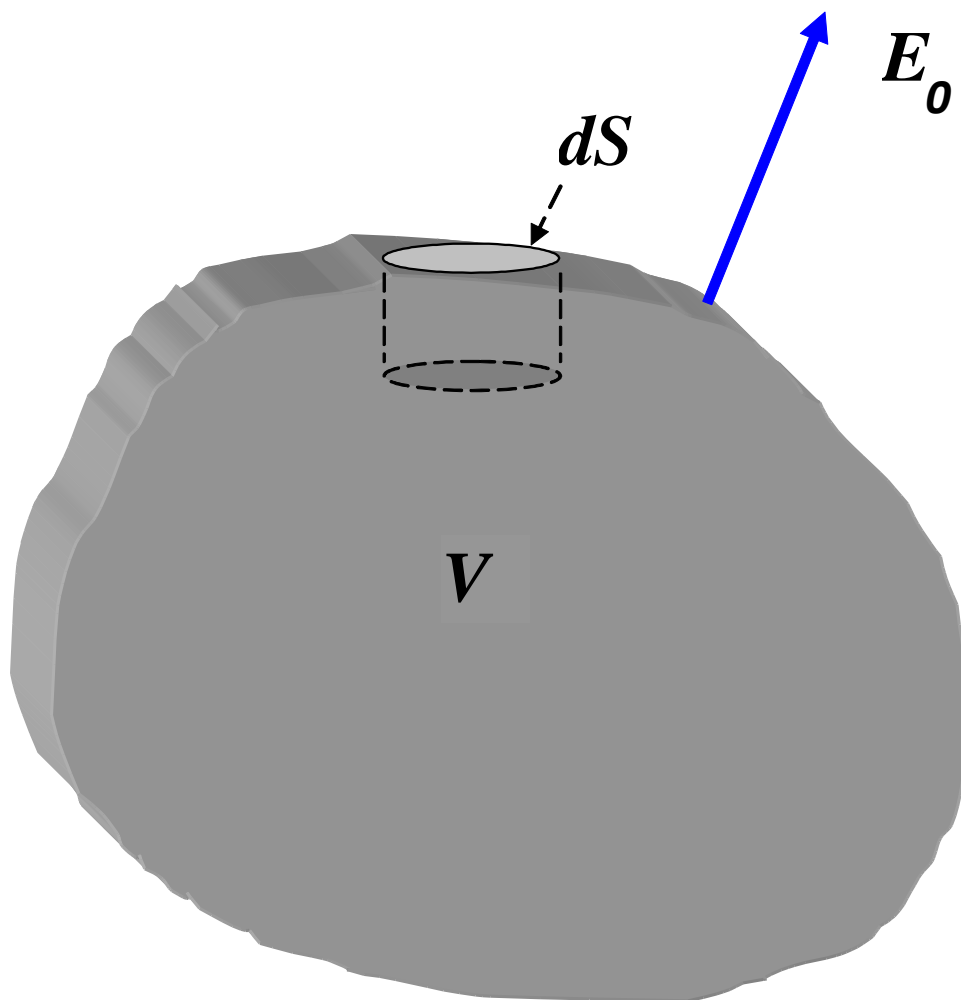
## Связь между вектором $P$ и $\sigma$

$$P_n = \sigma' = \chi \varepsilon_0 E$$

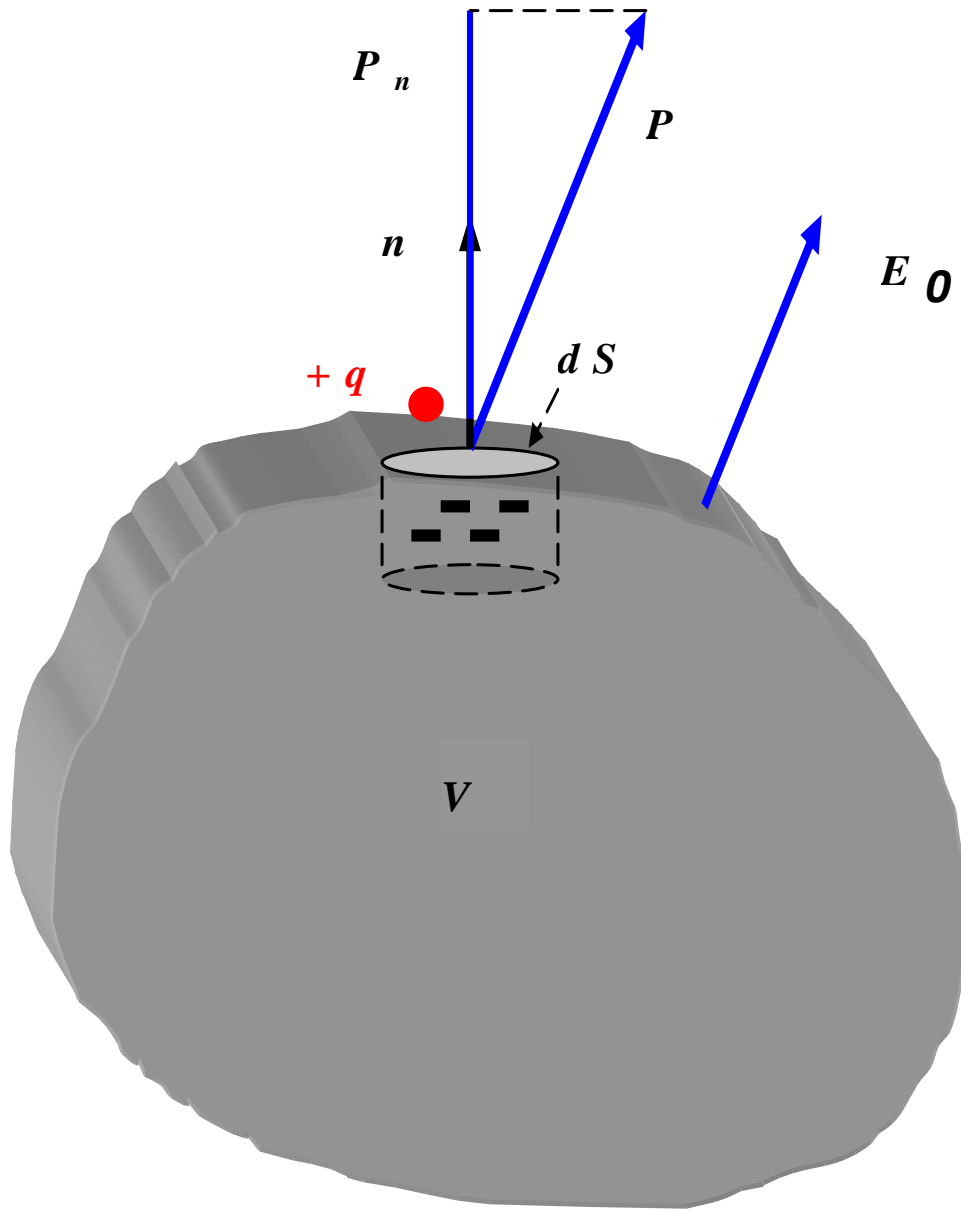
- $P_n$  – проекция вектора поляризованности на внешнюю нормаль к поверхности диэлектрика.
- $P_n$  численно равна электрическому заряду, смещаемому через единичную площадку в направлении положительной нормали к ней.

**Закон Гаусса для вектора поляризации  $P$**

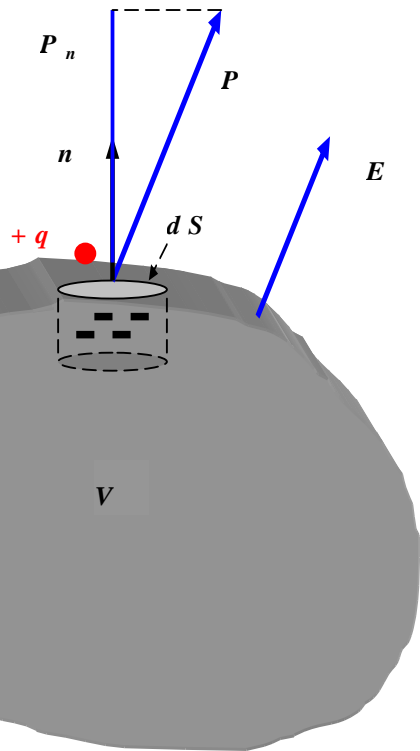
## Закон Гаусса для вектора поляризации $P$



# Закон Гаусса для вектора поляризации $P$



## Закон Гаусса для вектора поляризации $P$

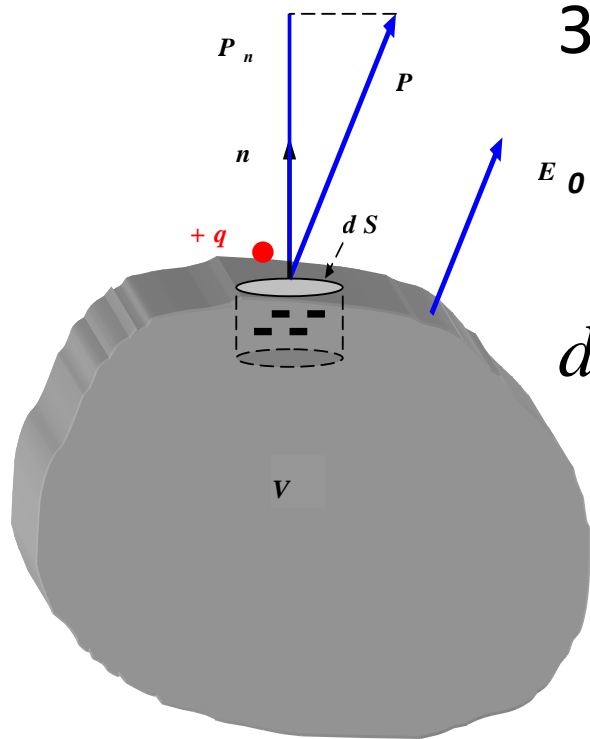


При включении поля через площадку  $dS$  в направлении вектора  $E_0$  сместятся положительные заряды, в объеме останутся отрицательные заряды.

Поверхностная плотность поляризационных зарядов

$$\sigma' = P_n$$

## Закон Гаусса для вектора поляризации $P$



Заряд, прошедший через площадку  $dS$ :

$$dq = \sigma' \cdot dS = P_n \cdot dS = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$dS \rightarrow 0$ , в окрестностях площадки:

$$E_0 = \text{const}, P = \text{const}.$$

Заряд, оставшийся в объеме под площадкой  $dS$ :

$$dq = -\vec{P} \cdot d\vec{S}$$



## Закон Гаусса для вектора поляризации $\vec{P}$

$$Q_{\text{выш}} = \sum q_{\text{выш}} = \oint_S dq = \oint_S \vec{P} d\vec{S}$$

$$Q_{\text{связ}} = \sum q_{\text{связ}} = - \sum q_{\text{выш}} = - \oint_S \vec{P} d\vec{S} = - \oint_S P_n dS$$

$$-Q_{\text{поляриз}} = \oint_S \vec{P} d\vec{S}$$

## Закон Гаусса для вектора поляризации $\mathbf{P}$

$$-Q_{\text{поляриз}} = \oint_S \vec{P} d\vec{S}$$

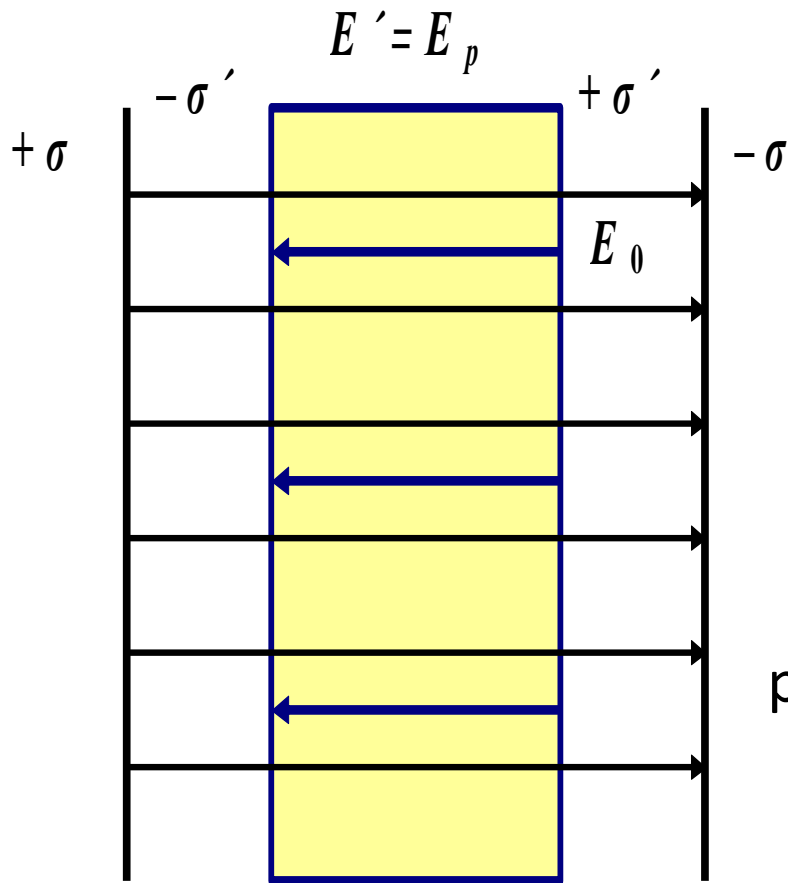
- Поток вектора поляризации  $\mathbf{P}$  через произвольную замкнутую поверхность  $S$  равен взятому с обратным знаком поляризационному заряду диэлектрика в объеме, охватываемом этой поверхностью.

## Вектор электростатической индукции.

- Поле в среде отличается от поля в вакууме тем, что оно создается как **свободными**, так и **связанными (поляризационными)** зарядами.
- Теорема Гаусса

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q_{\text{своб}} + q_{\text{пол}}}{\epsilon_0}$$

## Вектор электростатической индукции.



Свободные заряды создают внешнее поляризующее поле  $E_0$ , а связанные заряды – добавочное поле поляризованного диэлектрика  $E_p$ .

$$\vec{E}_p \uparrow \downarrow \vec{E}_0$$

результатирующее поле в диэлектрике:

$$E = E_0 - E_p < E_0$$

## Вектор электростатической индукции.

По теореме Гауса для векторов  $E$  и  $P$ :

$$\oint_S \varepsilon_0 \vec{E} d\vec{S} = q_{\text{своб}} + q_{\text{пол}} \quad \oint_S \vec{P} d\vec{S} = -q_{\text{пол}}$$

$$\Rightarrow \oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) d\vec{S} = q_{\text{своб}}$$

$$\boxed{\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}$$

вектор **электростатической индукции**  
**(электрического смещения).**

## Закон Гаусса для вектора электростатической индукции

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{\text{своб}}$$

**Поток** вектора электростатической (электрической) индукции через замкнутую поверхность  $S$  **равен алгебраической сумме свободных зарядов**, охватываемых этой поверхностью.

## Закон Гаусса для вектора электростатической индукции

Закон Гаусса для вектора  $\mathbf{D}$  в дифференциальном виде:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \operatorname{div} \vec{D} dV = \int_V \rho dV$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

## Связь между векторами $D$ и $E$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \qquad \vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \chi \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

$\varepsilon = 1 + \chi$  - **относительная диэлектрическая проницаемость.**

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

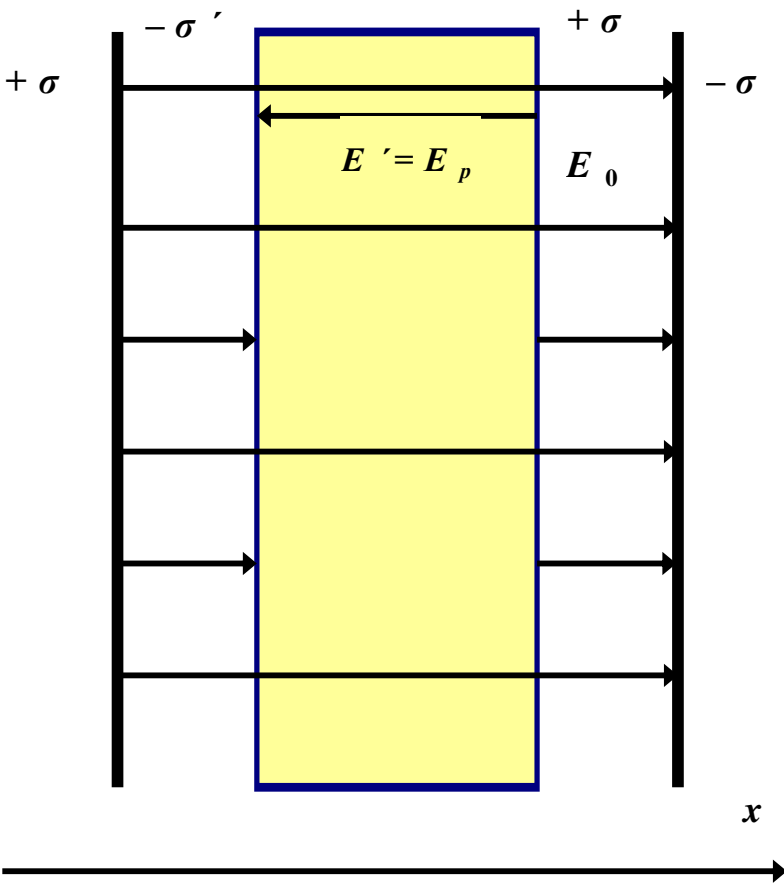


## Связь между векторами $D$ и $E$

$$\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}$$

Вектор  $D$  характеризует установившееся **электрическое поле**, создаваемое свободными зарядами, но при таком их распределении, какое имеет место при наличии диэлектрика.

# Относительная диэлектрическая проницаемость

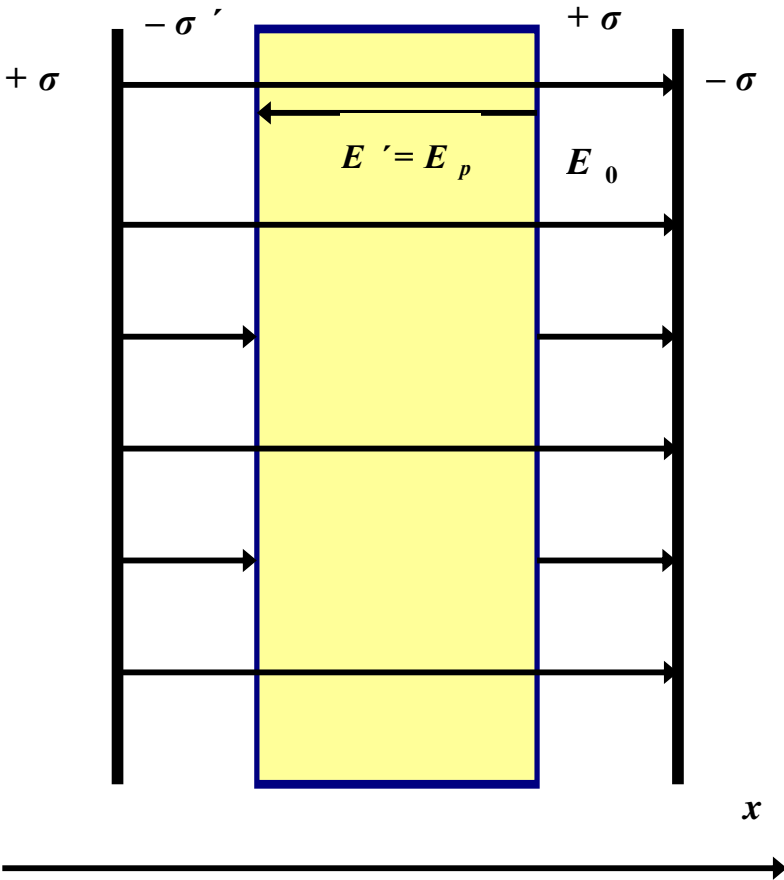


Внешнее поле  $E_0$  создается двумя бесконечными пластинами с поверхностной плотностью заряда  $+\sigma$  и  $-\sigma$ .

Результирующее поле в диэлектрике

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

# Относительная диэлектрическая проницаемость



В проекциях на ось  $x$ :

$$E = E_0 - E'$$

$$E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$

$$E = E_0 - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0}$$

$$P = \sigma' \quad \vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

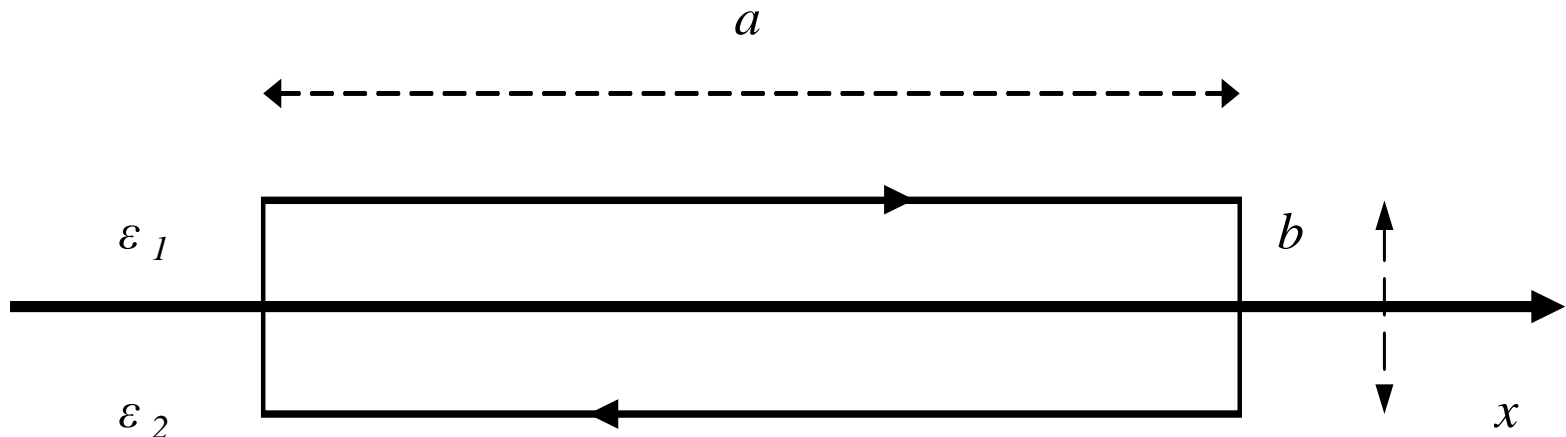
## Относительная диэлектрическая проницаемость

$$E = E_0 - \frac{\chi \varepsilon_0 E}{\varepsilon_0} \quad E_0 = (1 + \chi)E \quad \varepsilon = 1 + \chi$$

$$\varepsilon = \frac{E_0}{E}$$

Относительная диэлектрическая проницаемость среды показывает во сколько раз поле в вакууме  $E_0$  больше поля  $E$  в среде.

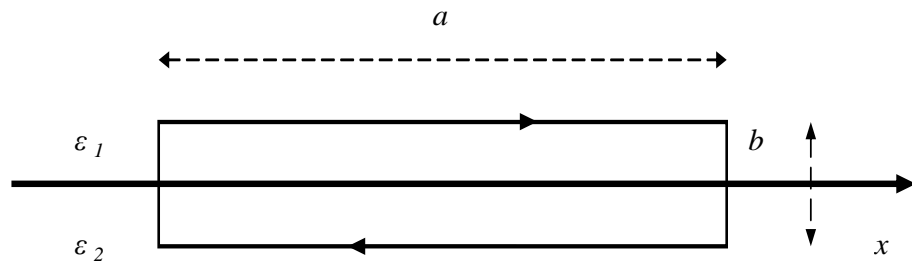
## Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



Прямоугольный контур  $a \times b$

Два соприкасающихся диэлектрика с различными диэлектрическими проницаемостями  $\epsilon_1$  и  $\epsilon_2$ , помещенные во внешнее электрическое поле.

# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



Циркуляция вектора  $E$   
по замкнутому контуру

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0$$

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = E_{1x} a - E_{2x} a + \langle E_n \rangle 2b$$

$$E_{1x} = E_{1\tau} \quad E_{2x} = E_{2\tau}$$

тангенциальные составляющие  $E$  в 1 и 2 диэлектрике

$\langle E_n \rangle$  – среднее значение  $E$  на участках контура перпендикулярных к границе.

## Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0 = E_{1x}a - E_{2x}a + \langle E_n \rangle 2b$$

$$(E_{2\tau} - E_{1\tau}) \cdot a = \langle E_n \rangle \cdot 2b$$

Сторона  $b$  контура мала:  $b \rightarrow 0$ .

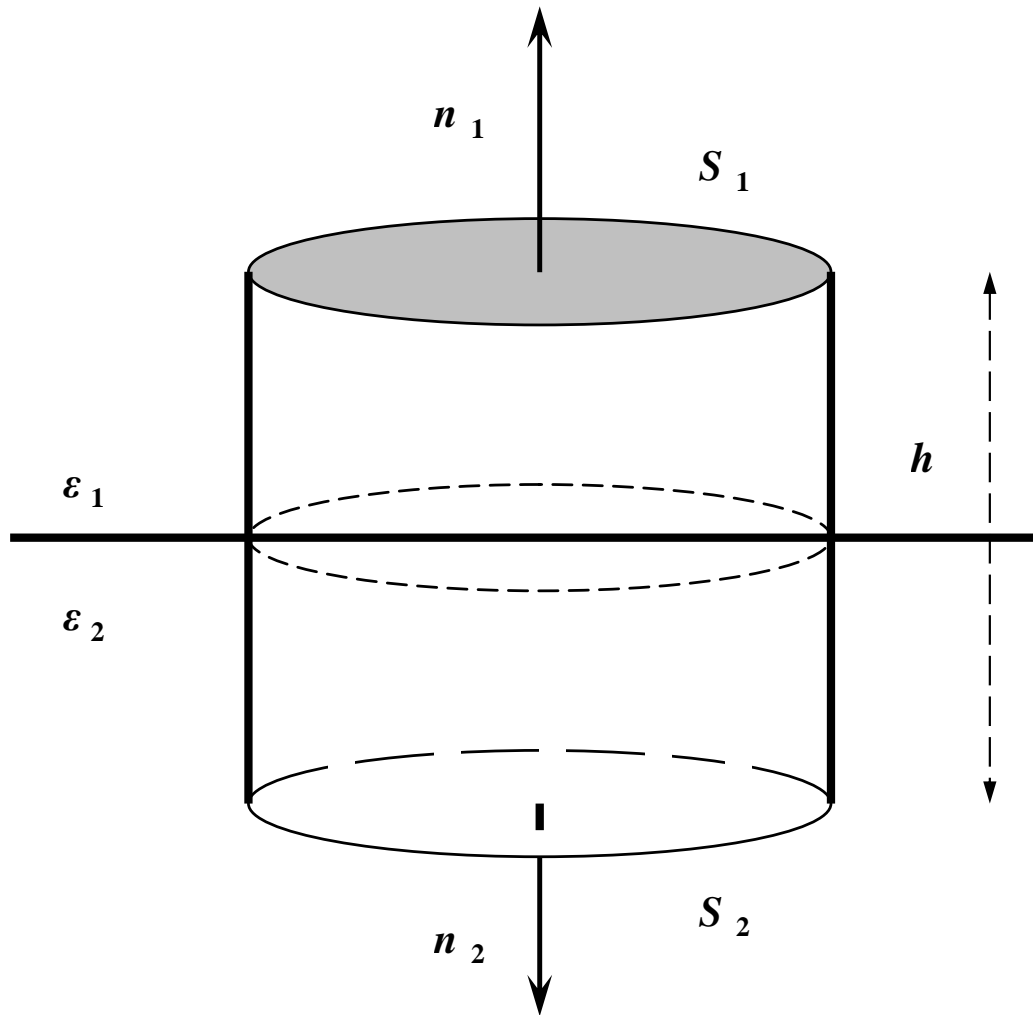
$$(E_{2\tau} - E_{1\tau}) \cdot a = 0$$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

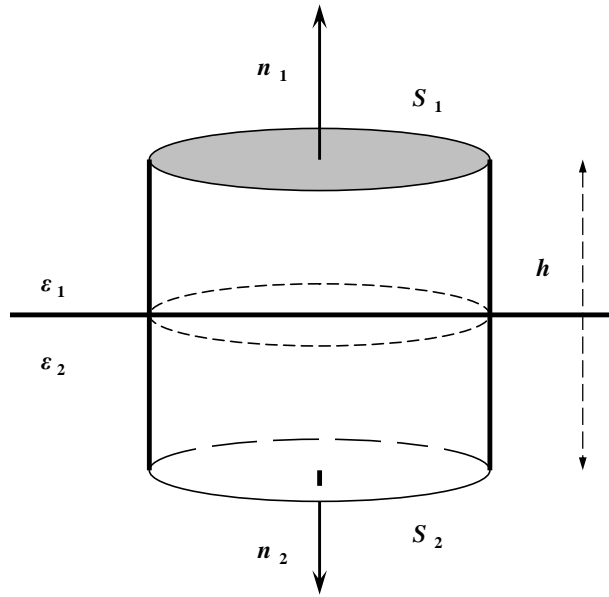


Возьмем на границе  
цилиндрическую  
поверхность высотой  $h$ .

Основание  $S_1$  расположено в первом диэлектрике,  
 $S_2$  – во втором диэлектрике.



# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



$$S_1 = S_2 = S \rightarrow 0.$$

Поле в пределах  $S$  - однородное.

Сторонних зарядов на границе 2-х диэлектриков нет.

$$\Phi_D = \sum q_i = 0$$

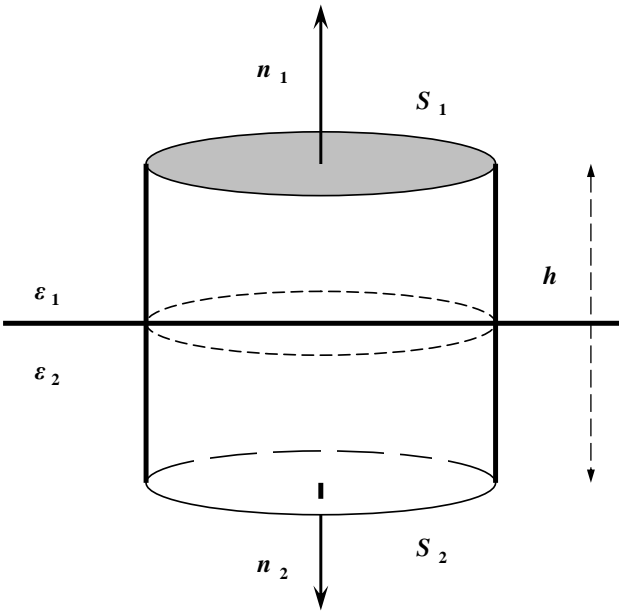
$$\Phi_D = D_{1n} S_{осн} + D_{2n} S_{осн} + \langle D_\tau \rangle S_{бок} = 0$$

$D_{1n}$  – проекция вектора  $D$  в первом диэлектрике на нормаль  $n_1$ ,

$D_{2n}$  – проекция вектора  $D$  во втором диэлектрике на нормаль  $n_2$ ,

$\langle D_\tau \rangle$  – значение  $D$ , усредненное по всей боковой поверхности.

# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



$$\Phi_D = D_{1n}S + D_{2n}S + \langle D_\tau \rangle S_{\text{бок}} = 0$$

$$h \text{ мала } (h \rightarrow 0) \quad S_{\text{бок}} \rightarrow 0.$$

$$D_{1n} = -D_{2n}$$

Если рассмотреть проекции векторов  $D_1$  и  $D_2$  на одну и ту же нормаль

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

## Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$\frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

При переходе через границу раздела двух сред

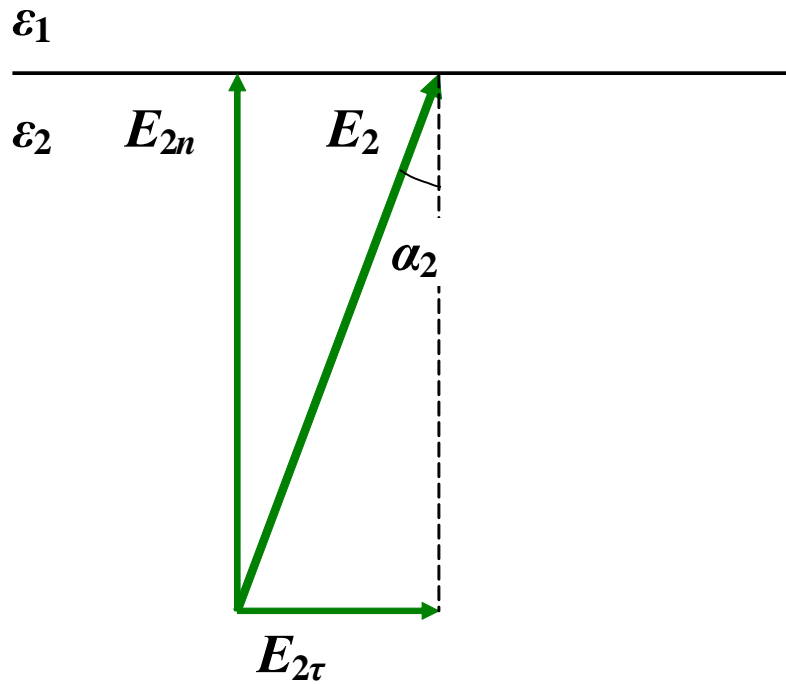
$D_n$  и  $E_\tau$  изменяются непрерывно  
(не претерпевают скачка)

$D_\tau$  и  $E_n$  претерпевают разрыв

Следствием этого является то, что линии напряженности электрического поля  $E$  и линии смещения  $D$  на границе двух диэлектриков претерпевают излом.

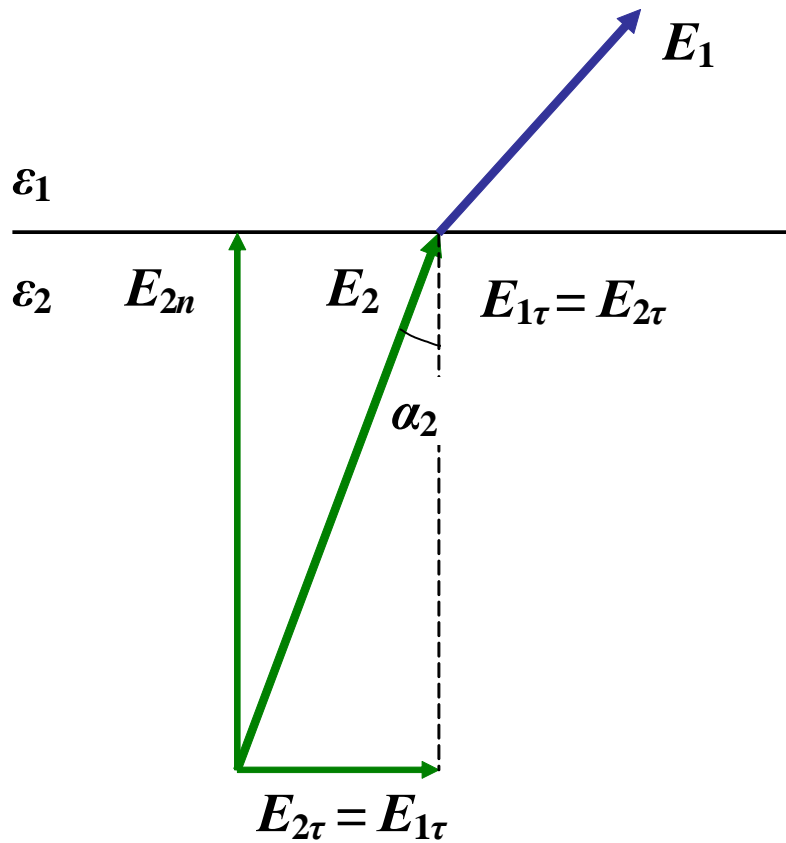
# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$$



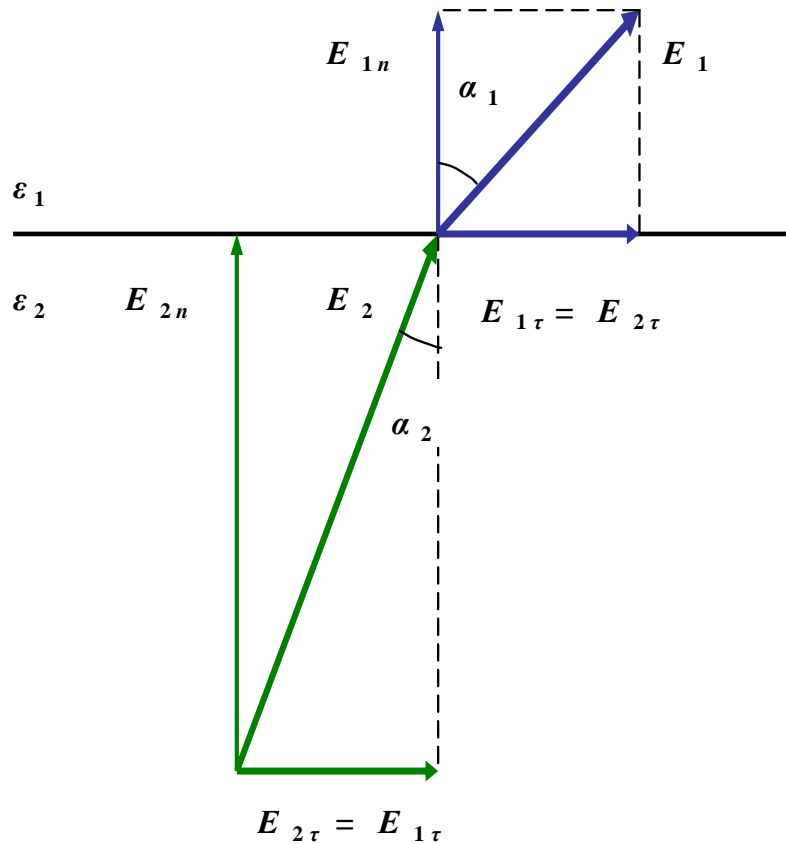
# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$$



# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

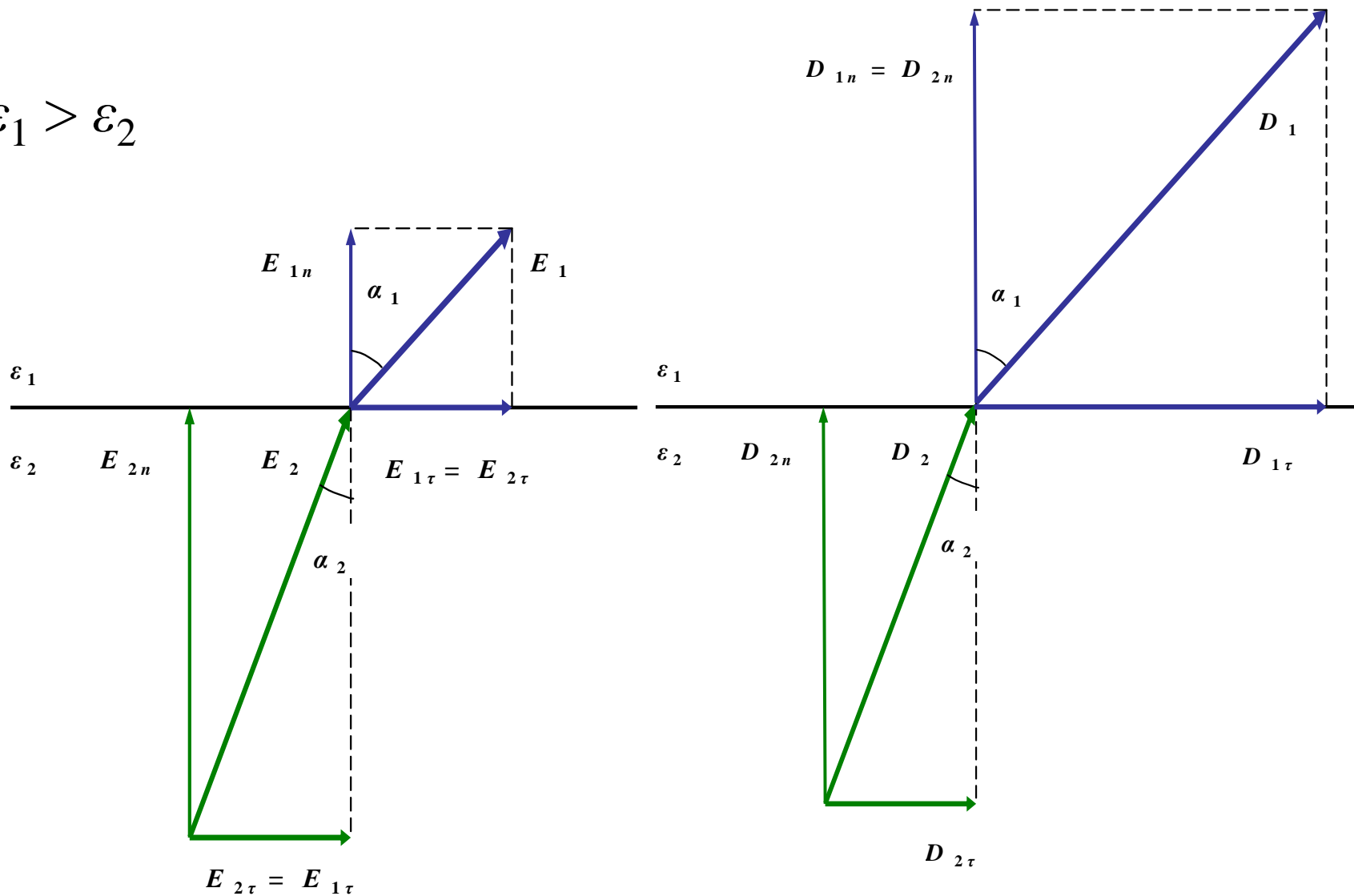
$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$$



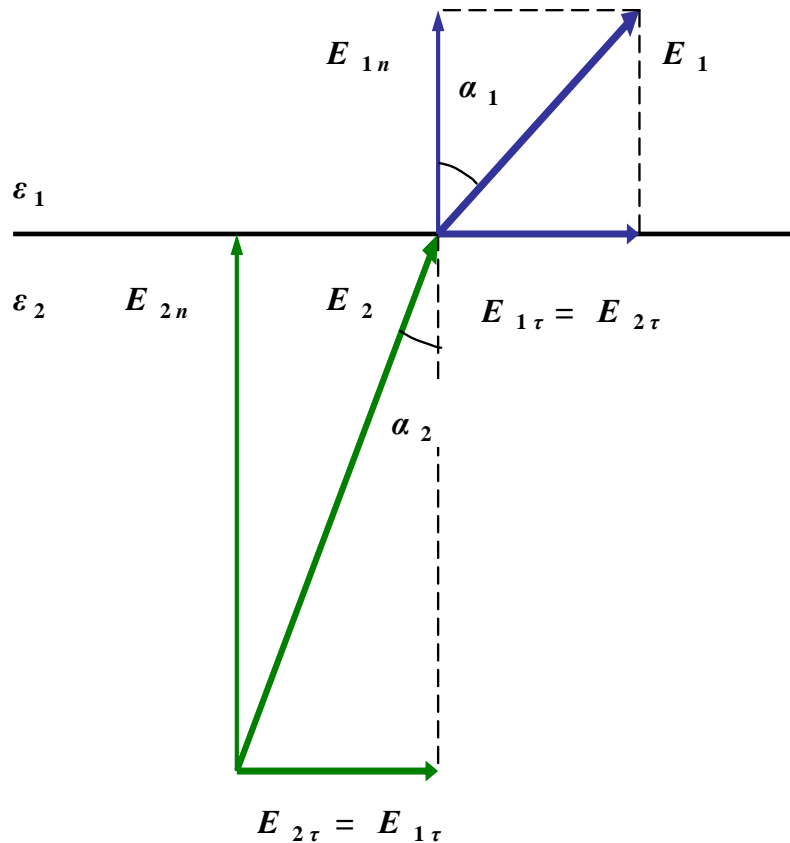
При переходе в диэлектрик с большим  $\varepsilon$  линии  $E$  и  $D$  удаляются от нормали

# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред

$$\epsilon_1 > \epsilon_2$$



# Условия на границе раздела двух диэлектрических сред



$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$$

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_1}{\operatorname{tg} \alpha_2} = \frac{\frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}}{\frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$



## Сегнетоэлектрики

- Существует группа веществ, которые обладают спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в отсутствие внешнего электрического поля.

Это явление было открыто первоначально для сегнетовой соли  $KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$



## Сегнетоэлектрики

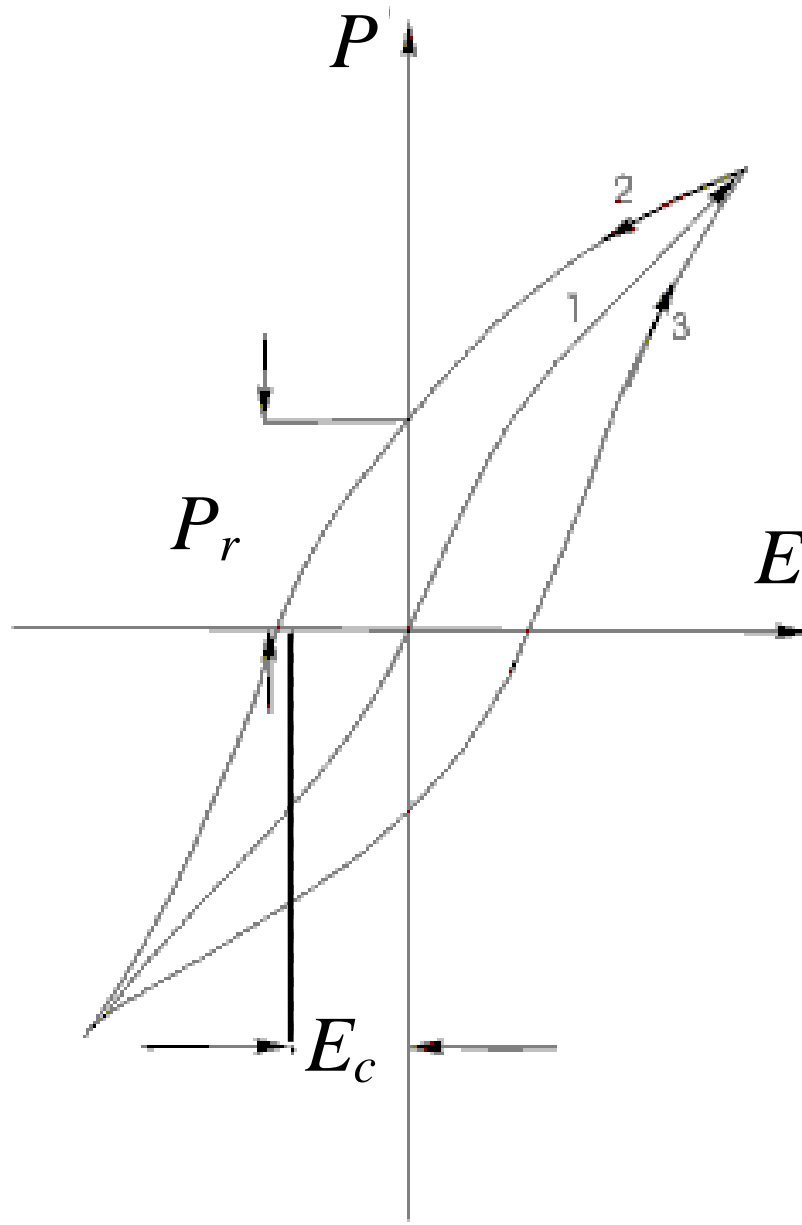
### Характерные особенности:

1. для сегнетовой соли  $\varepsilon=10000$
2. Зависимость  $D=f(E)$  не является линейной
3. При изменении поля значения вектора поляризации  $P$  отстают от напряженности поля  $E$ , в результате чего  $P$  определяется не только величиной  $E$  в данный момент, но и предшествующим значениями  $E$ .

Это явление называется **гистерезисом**.

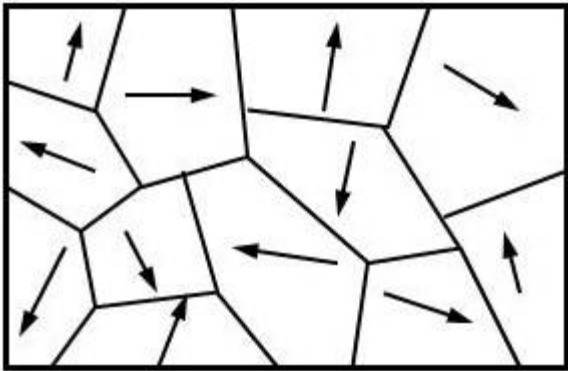
# Сегнетоэлектрики

$$P=f(E)$$



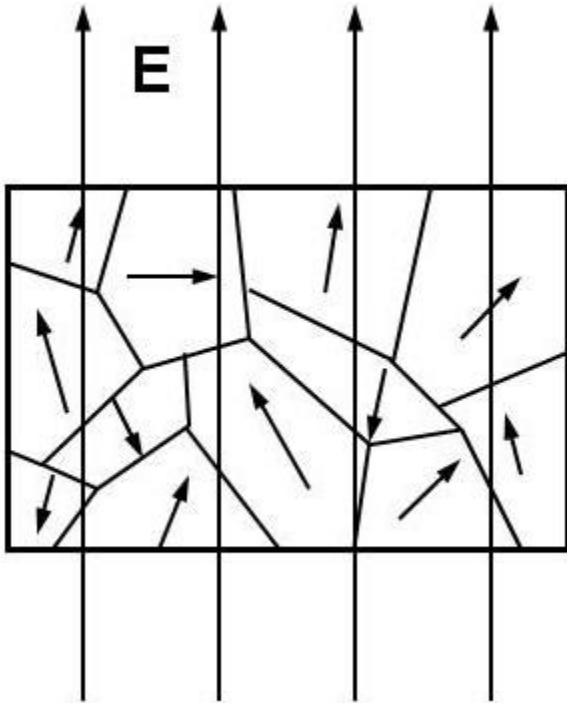
## Сегнетоэлектрики

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, в которых есть области *спонтанной поляризации* (**домены**), созданные силами хим. связей в кристалле.



## Сегнетоэлектрики

Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, в которых есть области *спонтанной поляризации* (**домены**), созданные силами хим. связей в кристалле.



Под действием внешнего электрического поля моменты доменов поворачиваются как целое, устанавливаясь в направлении поля.

Для каждого сегнетоэлектрика есть температура (*точка Кюри*), выше которой вещество утрачивает свои «особые» свойства.

# Пьезоэлектрики

**Прямой и обратный пьезоэлектрический эффекты**

**Самостоятельно!**

# Проводники в электрическом поле

## Проводники

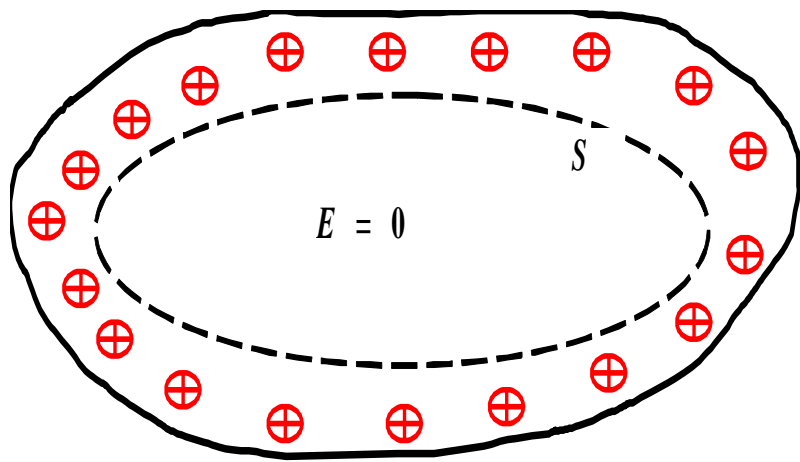
В проводниках имеются электрически заряженные частицы – *носители заряда*, которые способны под действием внешнего электрического поля перемещаться по всему объему проводника.

Носителями зарядов в твердых металлических проводниках являются электроны, которые называются *электронами проводимости* или *свободными электронами*.



## Равновесие зарядов в проводниках.

Проводнику сообщили заряд  $+q$

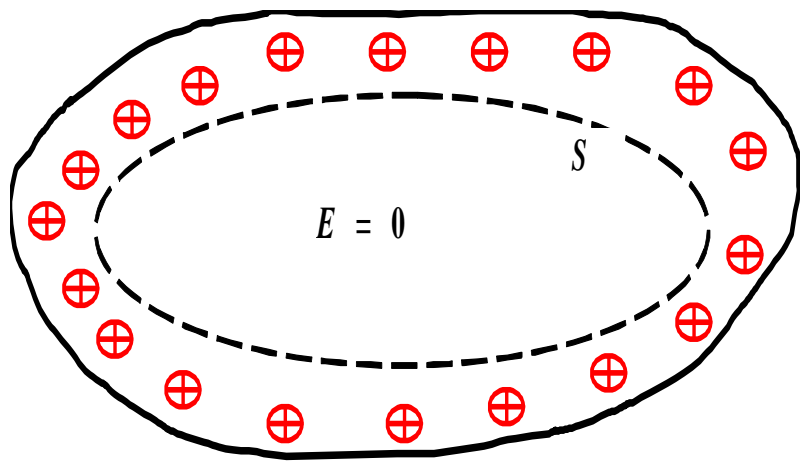


$$\vec{E} = 0$$

Если бы между любыми произвольно выбранными двумя точками проводника существовало поле, то возник бы и **электрический ток** без источника, что **противоречит** закону сохранения энергии.

## Равновесие зарядов в проводниках.

Проводнику сообщили заряд  $+q$



$$\vec{E} = 0$$

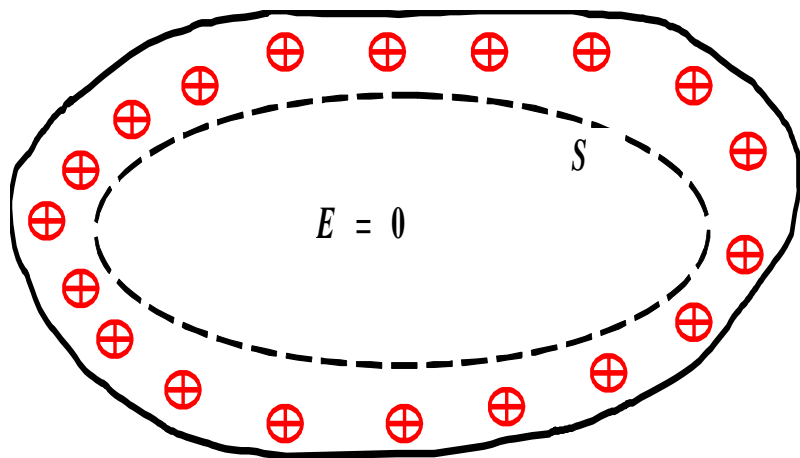
$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_V \frac{\rho dV}{\epsilon_0} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$S$  – произвольная замкнутая  
поверхность внутри проводника

$$\vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho = 0$$

## Равновесие зарядов в проводниках.

Проводнику сообщили заряд  $+q$



$$\rho = 0$$

В объеме проводника избыточные **заряды** отсутствуют и могут находиться только **на внешней поверхности проводника**.

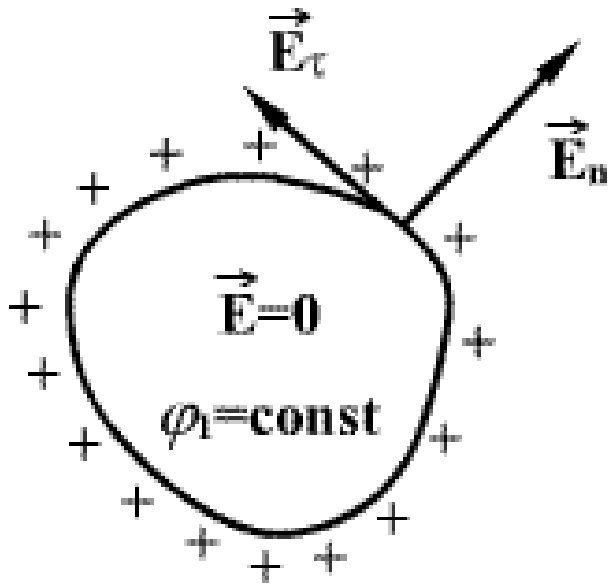
$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$$

$$\vec{E} = 0$$

$$\varphi = \text{const}$$

Любой **проводник** представляет собой **эквипотенциальное тело**, а его поверхность, естественно, является *эквипотенциальной*.

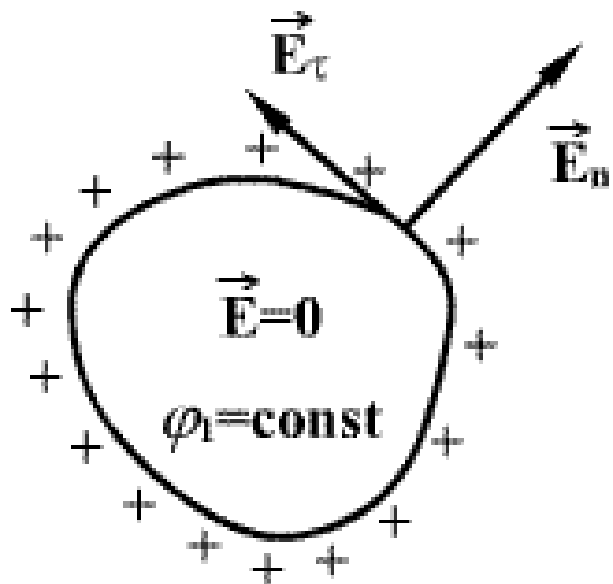
## Равновесие зарядов в проводниках.



На поверхности проводника вектор  $E$  должен быть направлен по нормали к этой поверхности.

Иначе под действием тангенциальной составляющей вектора напряженности  $E_\tau$  заряды бы перемещались по проводнику, что противоречит их статическому распределению.

## Равновесие зарядов в проводниках.



В равновесном состоянии:

1)  $E_{\text{внутр}} = E = 0.$

$$\vec{E} = -\text{grad}\varphi = -\vec{\nabla}\varphi$$

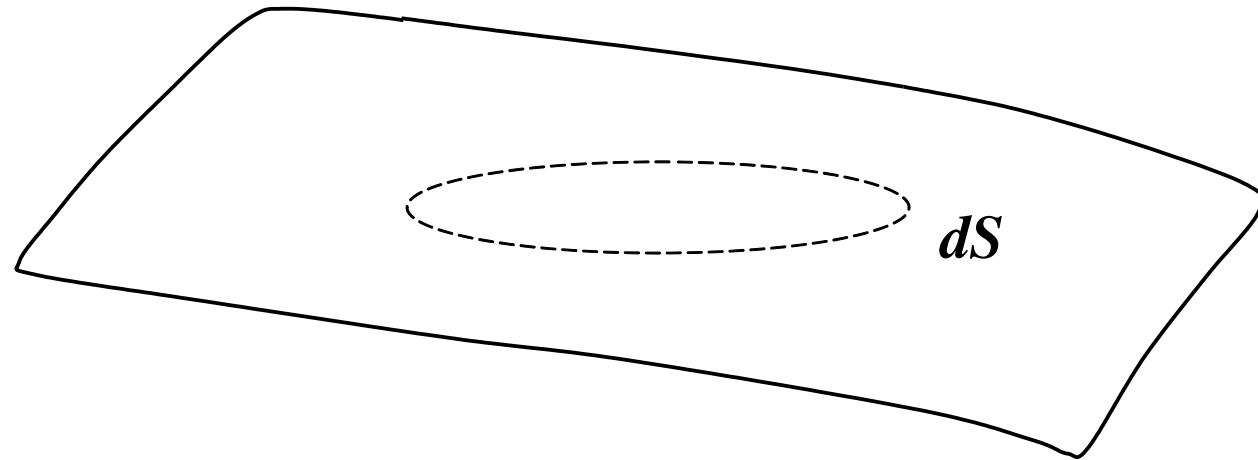
2)  $\varphi_{\text{внутр}} = \text{const}$  весь объем проводника и его поверхность **эквипотенциальны**.

3) На поверхности проводника  $\vec{E} = \vec{E}_n, \quad \vec{E}_\tau = 0.$

4)  $\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E} \quad \longrightarrow \quad \vec{D}_{\text{внутр}} = 0$

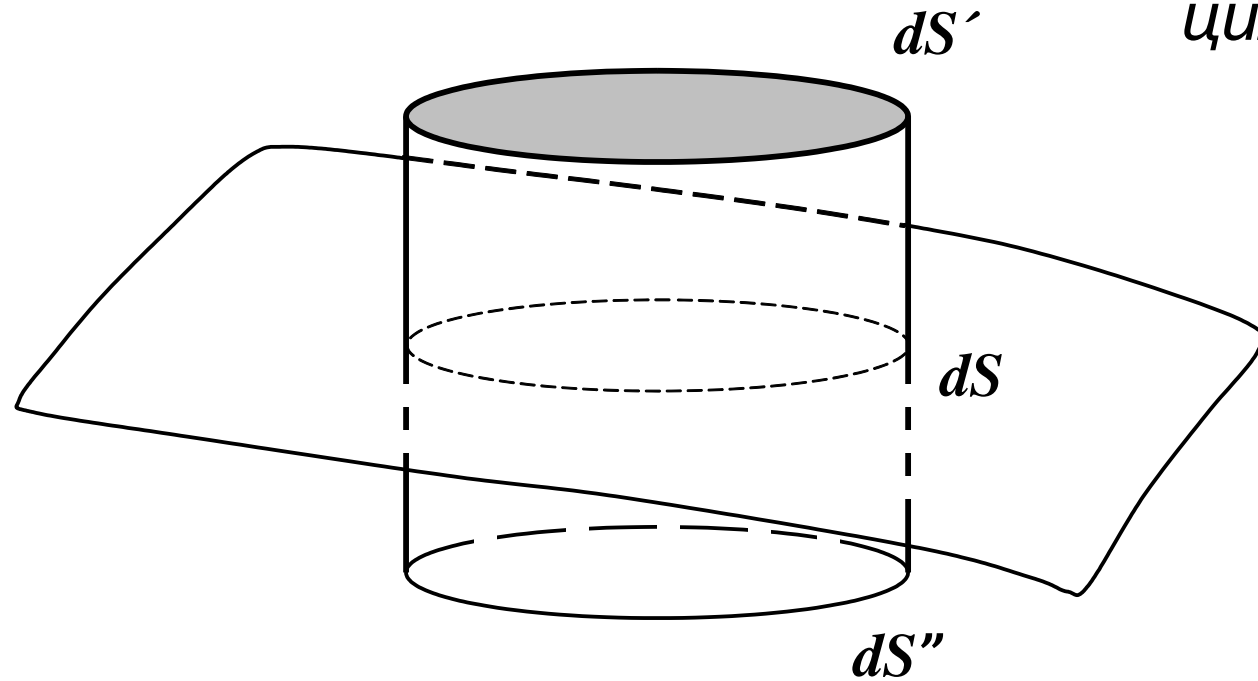
# Поле вблизи поверхности заряженного проводника

*Выделим на  
поверхности  
проводника  
произвольную  
площадку  $dS$ .*

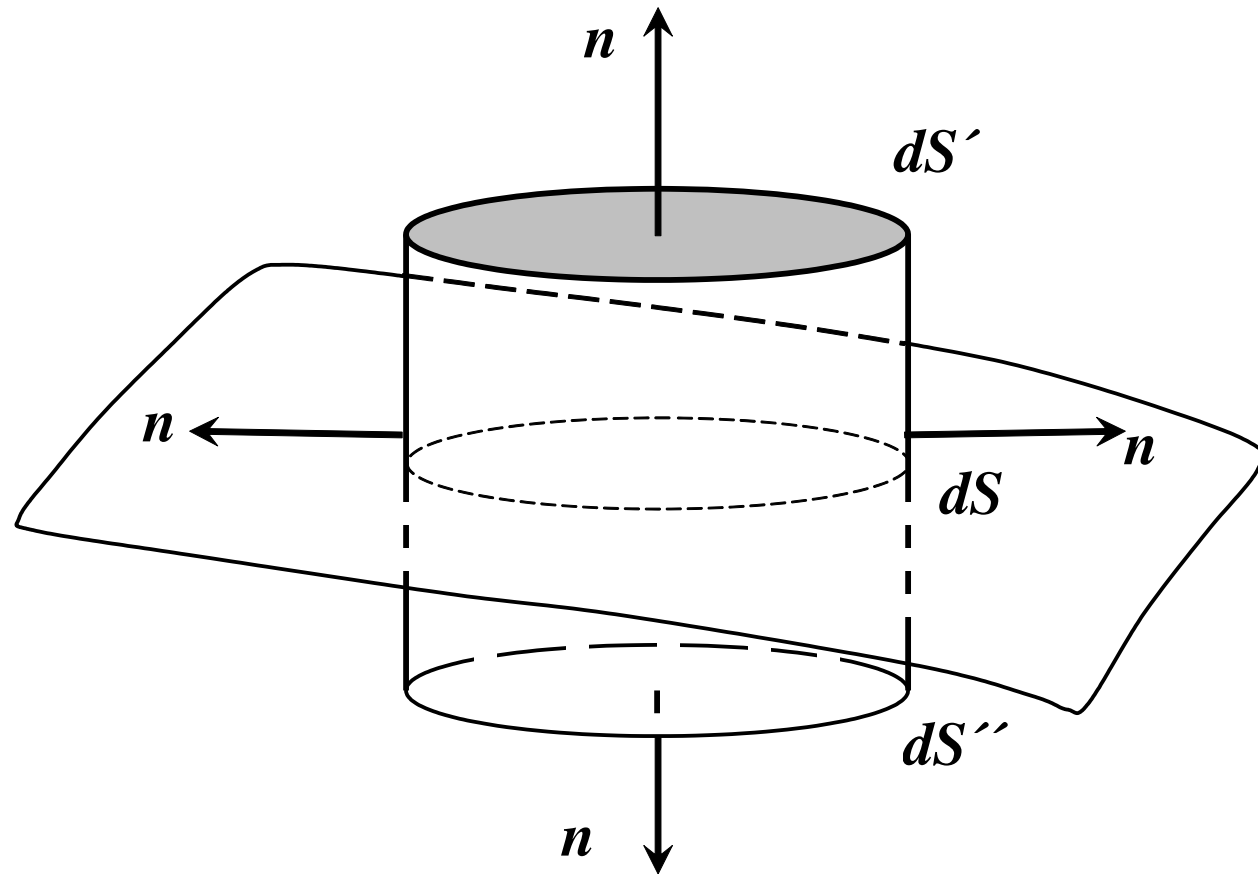


# Поле вблизи поверхности заряженного проводника

*Построим на ней  
цилиндр высотой  $dh$*

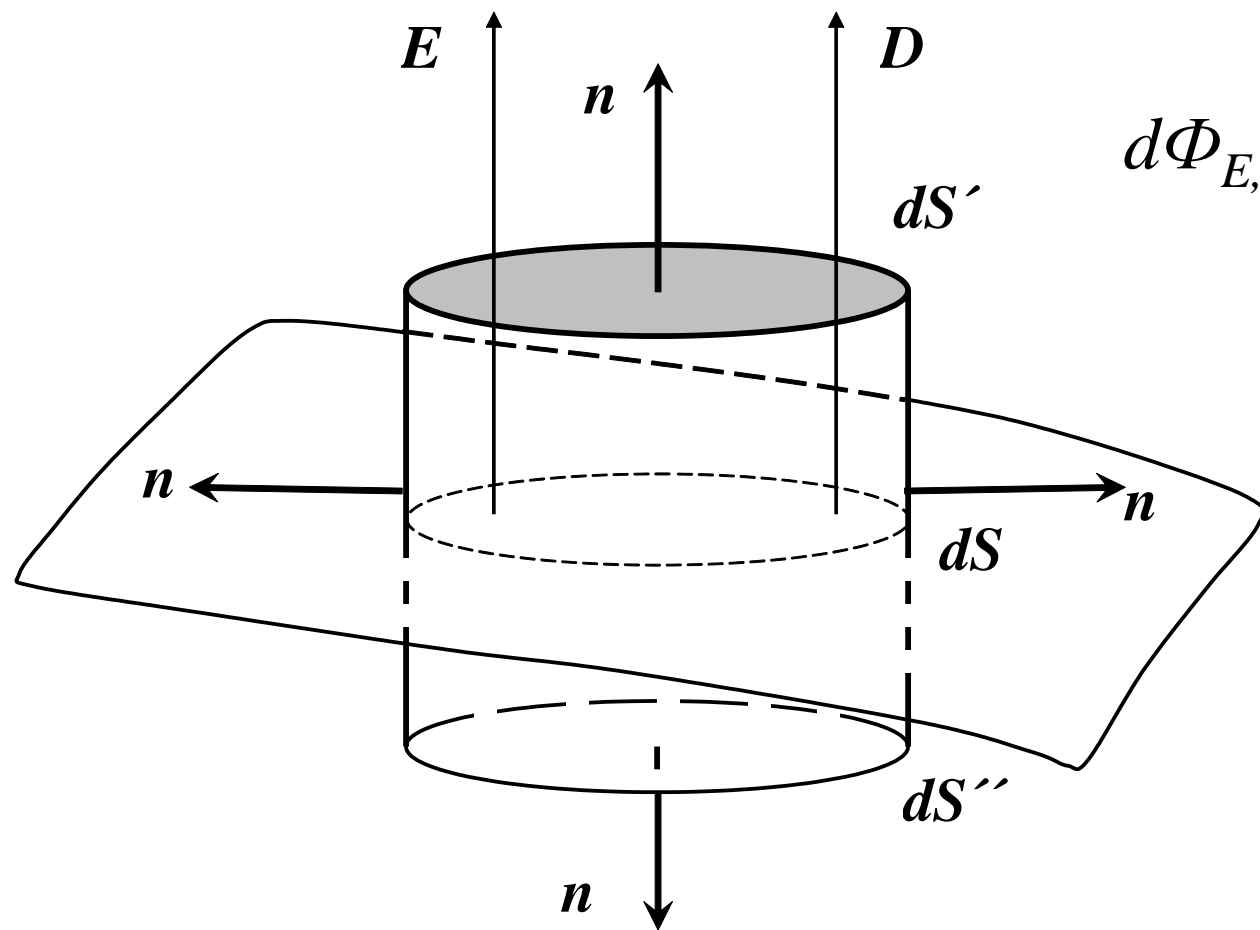


# Поле вблизи поверхности заряженного проводника





## Поле вблизи поверхности заряженного проводника

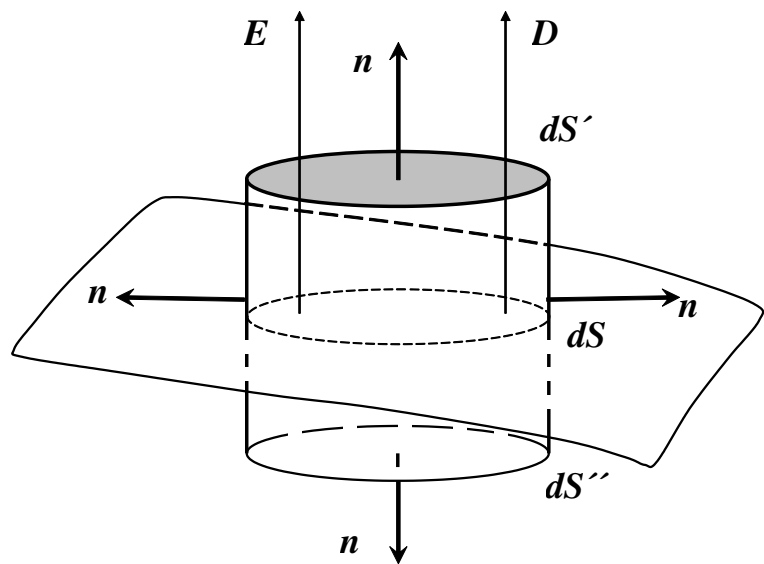


$$d\Phi_{E,D} \text{ бок.. поверхность} = 0.$$

$$\vec{D}_{\text{внутр}} = 0$$

$$d\Phi_D \text{ } dS'' = 0$$

## Поле вблизи поверхности заряженного проводника



$$d\Phi_D = d\Phi_D dS' = D_n \cdot dS.$$

*Теорема Гаусса для  $D$ :*

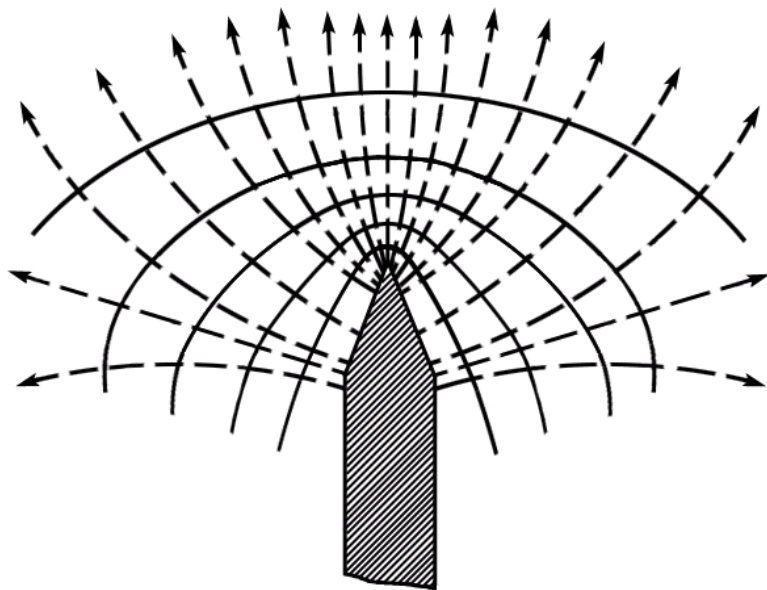
$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = dq = \sigma \cdot dS$$

$$D_n = \sigma$$

$$\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}$$

$$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon}$$

## Поле вблизи поверхности заряженного проводника



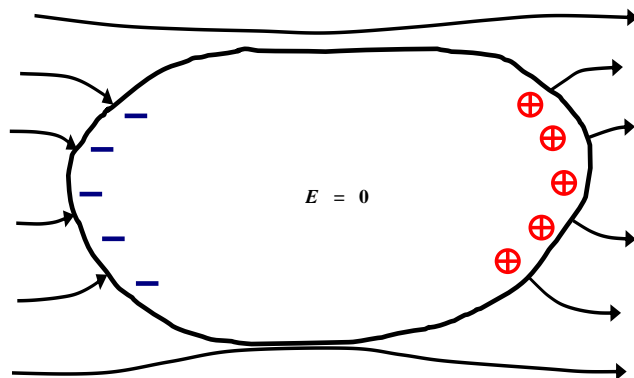
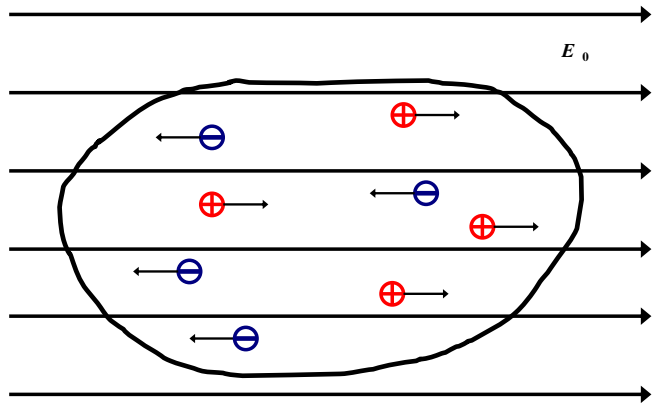
Вектор  $E$  вблизи поверхности проводника зависит от кривизны поверхности проводника.

$$C = \frac{1}{R}$$

Распределение зарядов по внешней поверхности проводника зависит только от её формы.

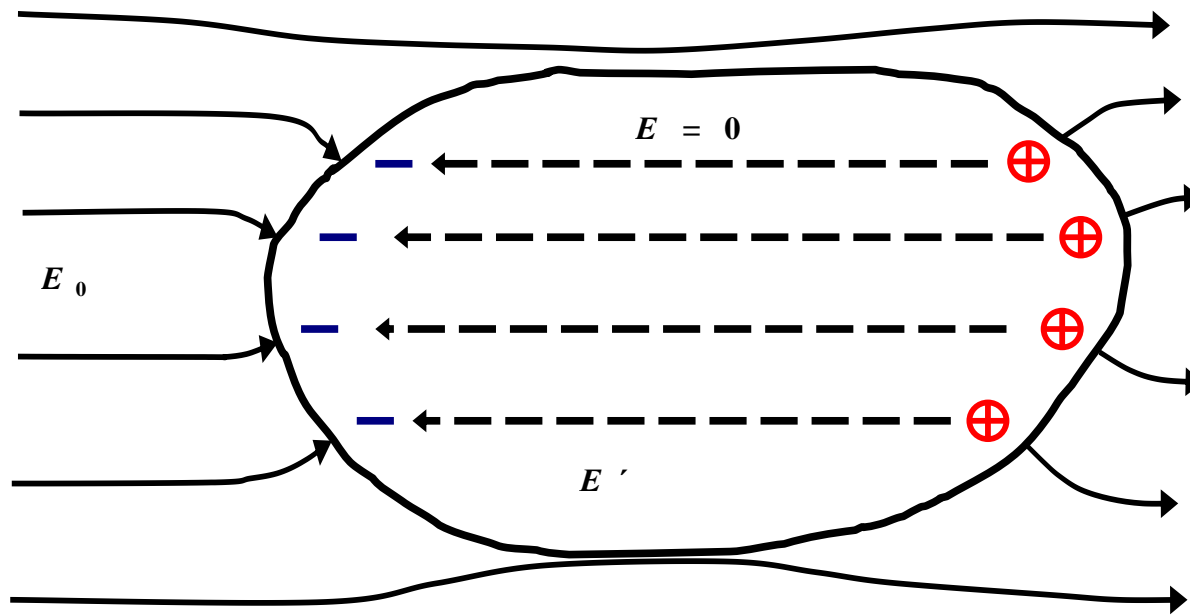
На внутренней поверхности замкнутых полых проводников  $\sigma = 0$ .

# Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция.

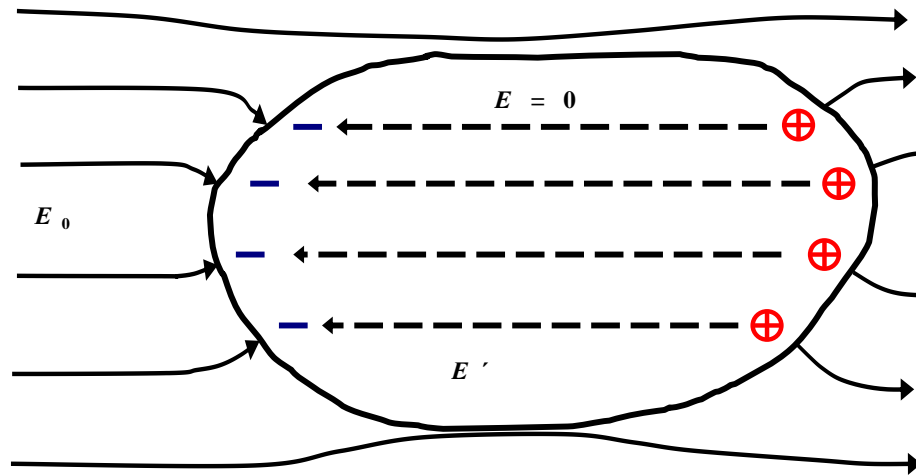


Электроны проводимости и положительные ионы перераспределяются до тех пор пока внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не **скомпенсировывает** внешнее поле.

**Электростатическая индукция** — явление перераспределения поверхностных зарядов на проводнике во внешнем электростатическом поле.

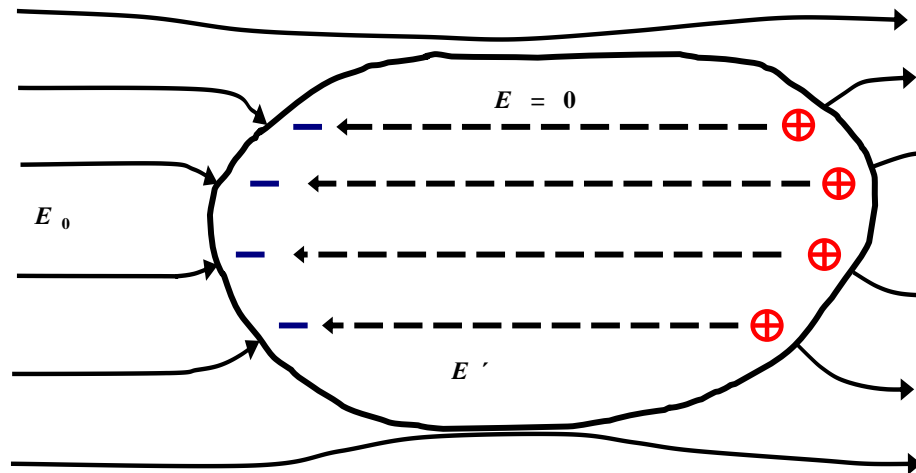


# Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция.



Нейтральный проводник, внесенный в электростатическое поле, разрывает часть линий напряженности, они заканчиваются на отрицательных **индуцированных зарядах** и вновь начинаются на положительных.

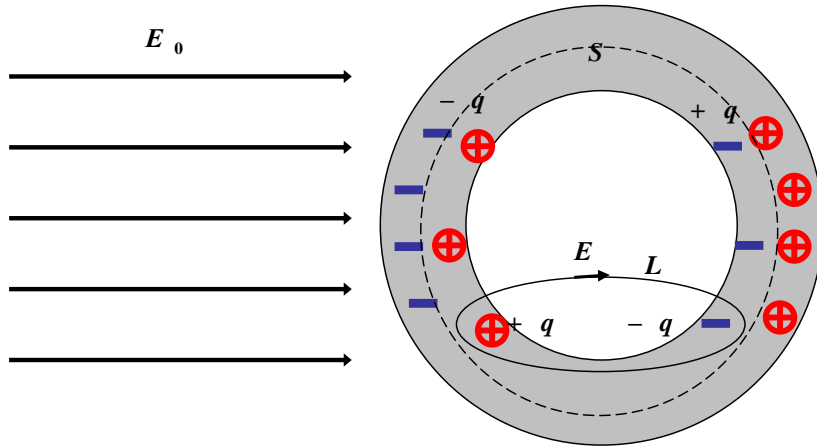
# Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция.



**Индукцированные** (наведенные) на проводнике заряды исчезают, когда проводник удаляют из электрического поля.

# Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция.

Электрическое поле в полости проводника



$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = 0$$

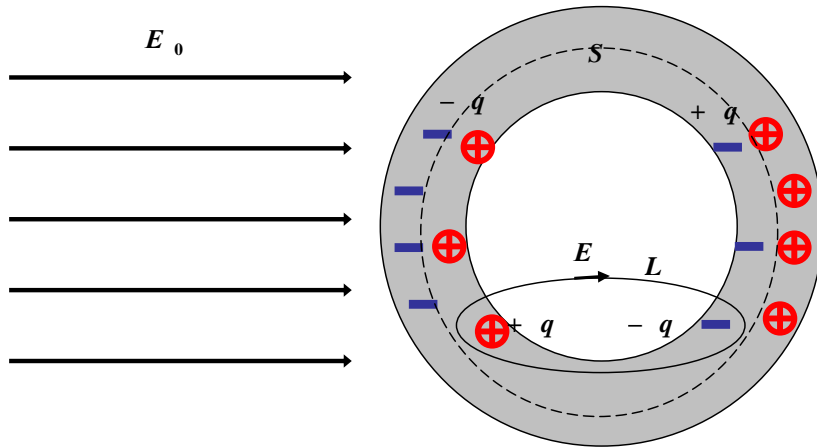
$$\sum q = 0$$

$$\sum q = q_+ + q_-$$



# Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция.

Электрическое поле в полости проводника



**Если** работа по перемещению заряда в полости  $\neq 0$ .

Следовательно, работа по перемещению заряда по замкнутому контуру  $L$  отлична от нуля и

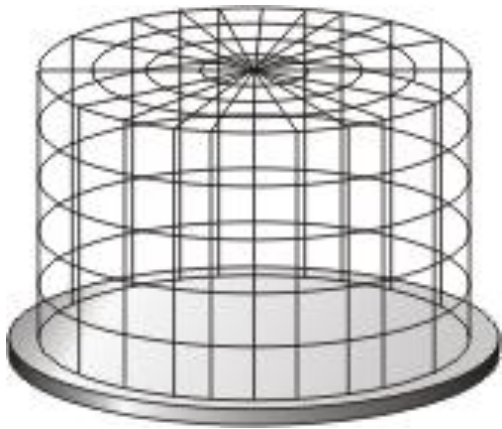
$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} \neq 0$$

что **невозможно** для кулоновских сил.

**Поэтому заряды и электростатическое поле внутри полости металла, находящегося в электрическом поле, отсутствуют.**

## Электростатическая защита

На этом основана электростатическая защита – экранирование тел (измерительные приборы, колебательный контур) от влияния внешних электрических полей.



**Опыт Кавендиша**

**Самостоятельно!**

# Электроемкость проводника

## Електроемкость уединенного проводника

**Уединенный проводник** – проводник, вблизи которого нет других тел, способных повлиять на распределение зарядов на нем.

Проводнику сообщили заряд  $q$ , который распределился по поверхности проводника так, что внутри проводника поле  $E = 0$ .

Если сообщить проводнику дополнительный заряд, поле внутри  $E = 0$ , а потенциал на поверхности измениться.

## Электроемкость уединенного проводника

Вблизи поверхности  
проводника

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad E \sim \sigma \sim q$$

$$\int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r} = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\varphi_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \int_r^{\infty} \vec{E} d\vec{r} = \varphi$$

$$E \sim \varphi$$

$$E \sim q$$



$$q = C\varphi$$

$C$  – коэффициент пропорциональности  
(электроемкость).

## Электроемкость проводника

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

В СИ  $C$  измеряется в фарадах [ $1\text{Ф} = 1\text{Кл} / 1\text{В}$ ].

**Электроемкость проводника** – это физическая величина численно равная заряду, который необходимо сообщить проводнику, чтобы увеличить его потенциал на **1В**.

## Электроемкость шара

$$E = -\frac{d\varphi}{dr} \quad E dr = -d\varphi$$

Вне шара:  $r \geq R$ ,  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$

$$\int_R^{\infty} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} = -\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi$$



## Електроємкость шара

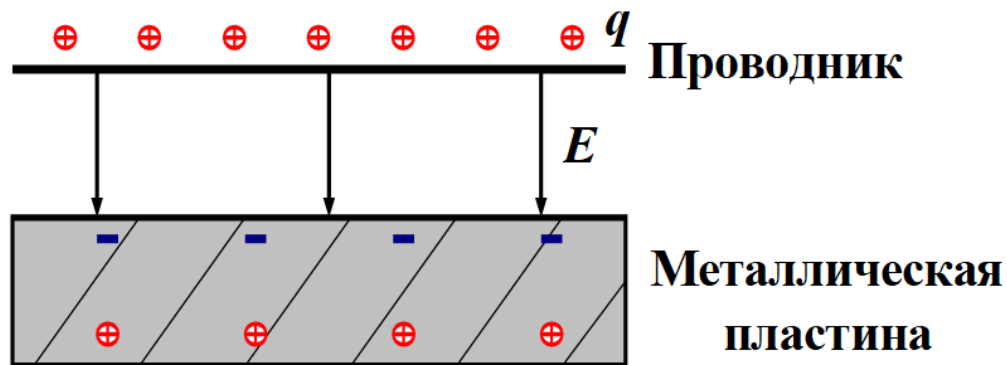
$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int_R^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \varphi_1 - \varphi_2, \quad \varphi_2 = \varphi_{\infty} = 0$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} = \varphi \quad C = \frac{q}{\varphi}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R$$

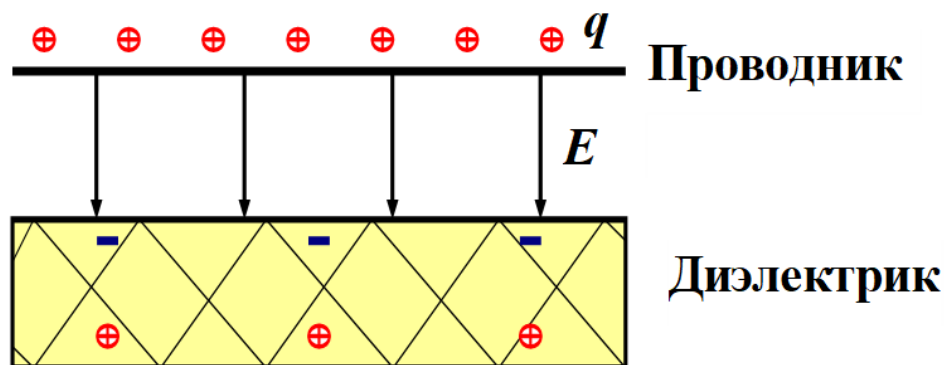
Електроємкость провідника залежить від його форми і розмерів, своєств о́кружаючої середы ( $\epsilon$ ).

## Взаимная емкость



$$\varphi = \varphi_+ + \varphi_-; \varphi < \varphi_+$$

$$q = \text{const}$$



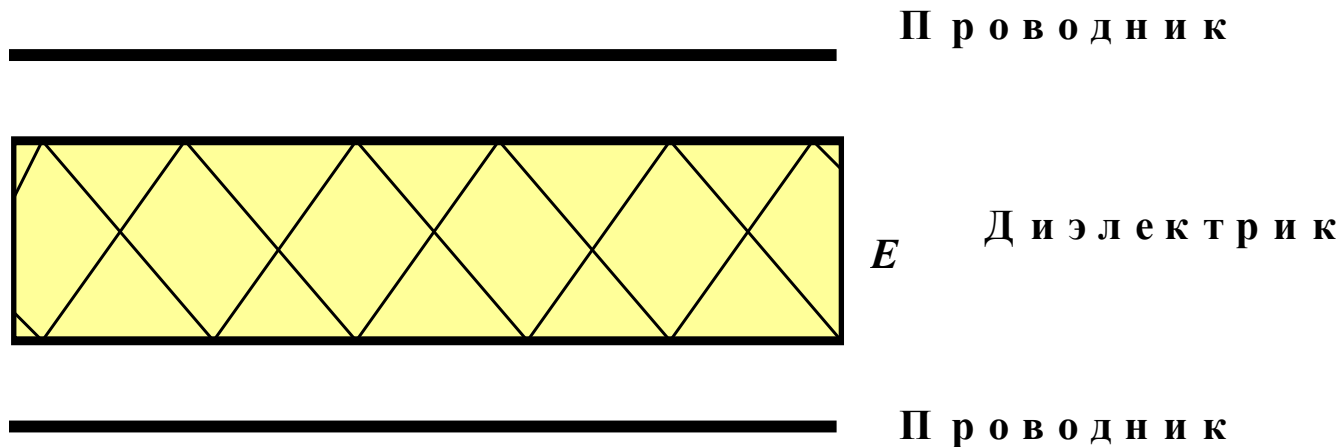
$$C = q / \varphi - \text{увеличится.}$$

Взаимная емкость больше, чем емкость уединенного проводника.

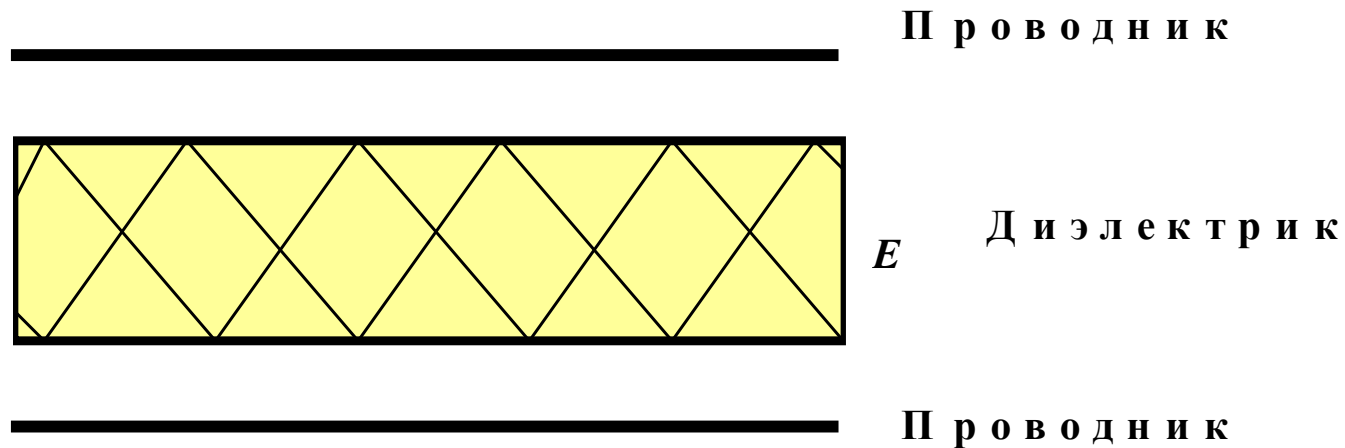
# Конденсаторы

*Особенно большой электроемкостью обладает конденсатор.*

**Конденсатор** – система из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, продольные размеры которых много больше расстояния между ними.



# Конденсаторы



Конденсаторы конструируют таким образом, чтобы поле было сосредоточено между обкладками.

В этом случае на емкость конденсатора не оказывают влияния окружающие тела.

## Конденсаторы

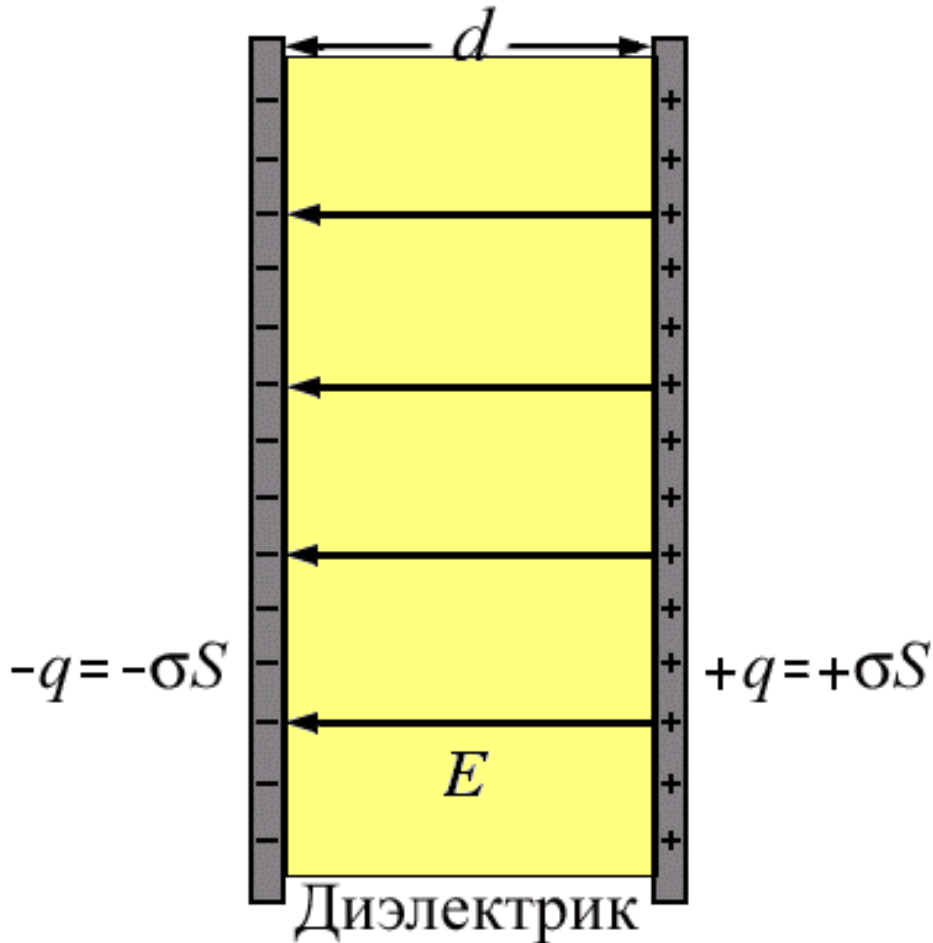
Конструктивно конденсаторы бывают ***плоские, цилиндрические, сферические.***

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$

$\varphi_1 - \varphi_2$  – разность потенциалов между обкладками;

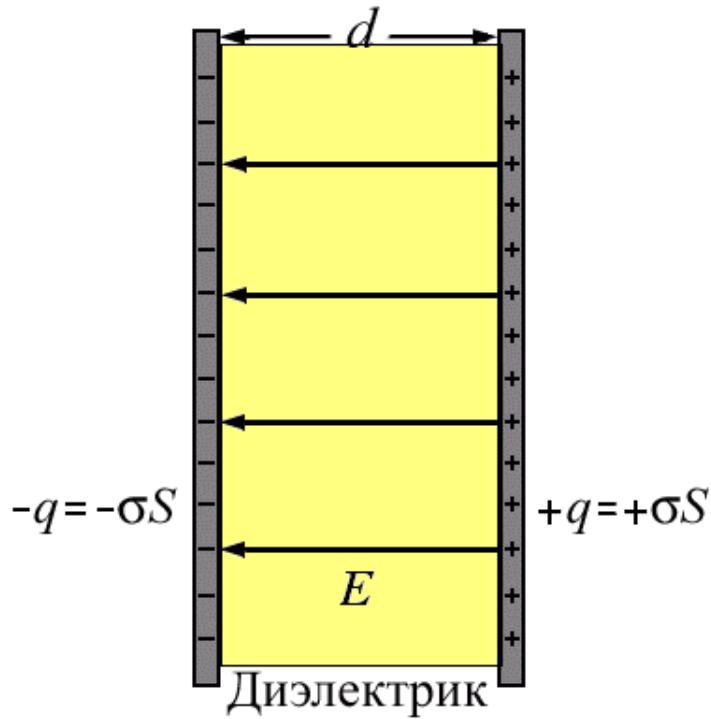
$q$  – заряд конденсатора.

## Плоский конденсатор



Расстояние между обкладками  $d$  много меньше линейных размеров конденсатора. Следовательно, поле конденсатора можно рассматривать как поле между двумя бесконечными пластинами.

## Плоский конденсатор



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0} \quad E = -\frac{d\varphi}{dr}$$

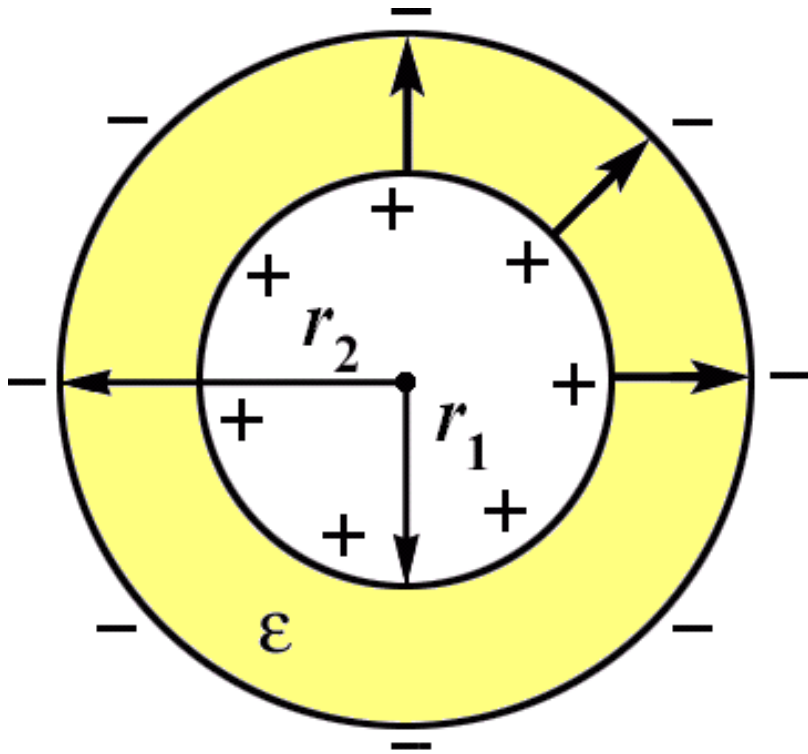
$$\int_0^d \frac{\sigma dr}{\epsilon \epsilon_0} = -\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi$$

$$\frac{\sigma \cdot d}{\epsilon \epsilon_0} = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$q = \sigma S$$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$$

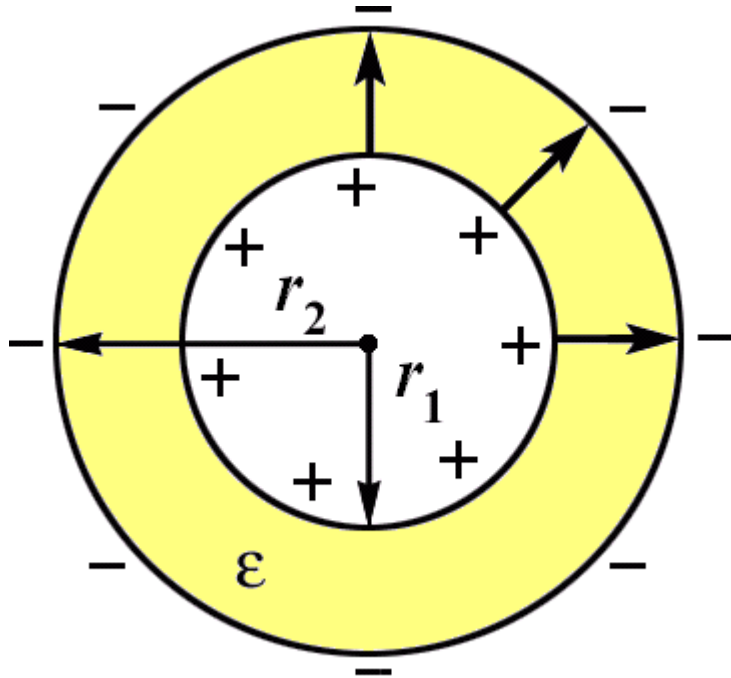
## Сферический конденсатор



Состоит из двух  
концентрических  
обкладок  
сферической  
формы,  
разделенных слоем  
диэлектрика.



## Сферический конденсатор



Поле равномерно заряженной сферической поверхности (вне сферы) эквивалентно полю точечного заряда:

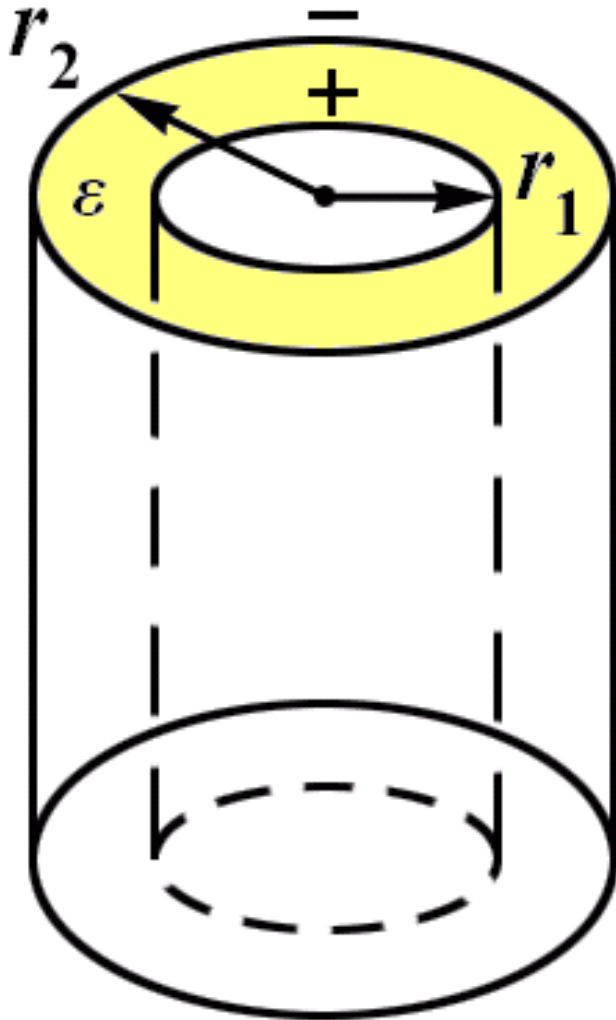
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



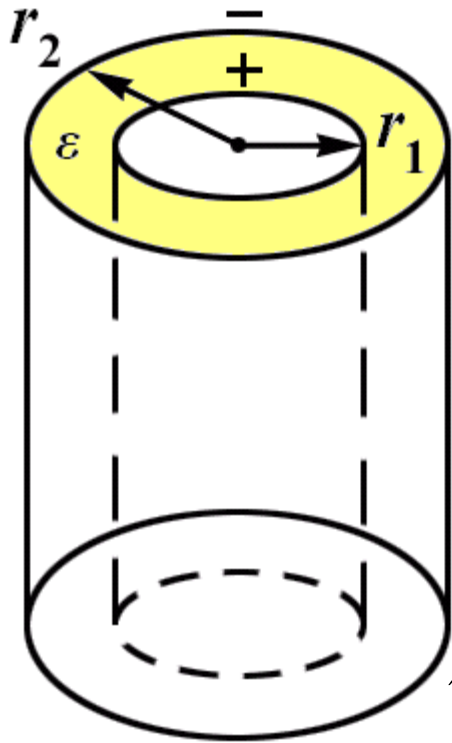
$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = 4\pi\epsilon\epsilon_0 \frac{r_1 \cdot r_2}{r_2 - r_1}$$

## Цилиндрический конденсатор



Состоит из двух полых коаксиальных цилиндров с радиусами  $r_1$  и  $r_2$ , вставленных один в другой ( $r_1 < r_2$ ) и разделенных слоем диэлектрика.

## Цилиндрический конденсатор



$r_1 < r_2$ ;  $r_1, r_2 < \text{длины}$

поля бесконечного заряженного цилиндра:

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{\tau}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$\tau = \frac{q}{l}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

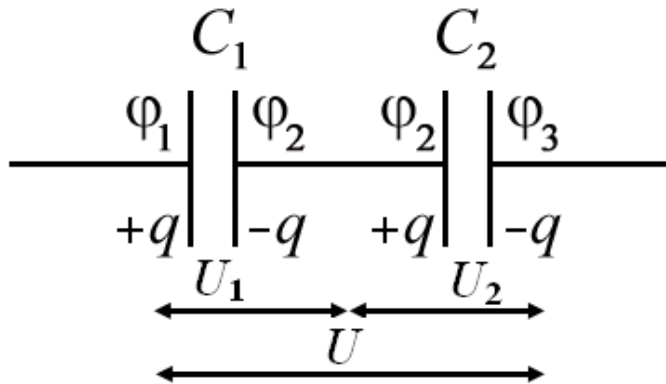
$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

## Конденсаторы

Конденсаторы характеризуются пробивным напряжением – разность потенциалов, при которой происходит пробой – электрический разряд через слой диэлектрика. Пробивное напряжение зависит от формы обкладок, свойств диэлектрика и его толщины.

## Соединения конденсаторов

### Последовательное соединение конденсаторов



$$C = \frac{q}{U}$$

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}$$

Для  $n$  конденсаторов:

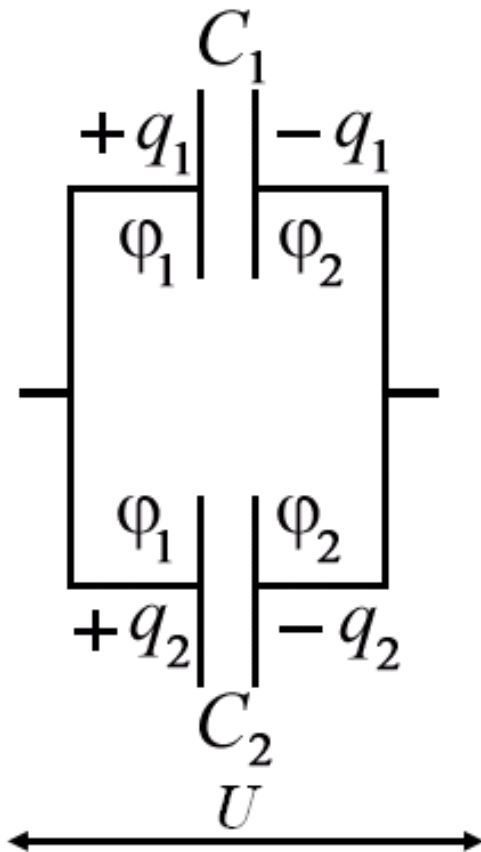
$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

$$C < C_1, C < C_2$$

Если конденсаторы одинаковы, то общая емкость  $C = C / n$ .

# Соединения конденсаторов

## Параллельное соединение конденсаторов



- Разность потенциалов на обкладках конденсаторов одинакова и равна  $U$ .
- Заряд батареи согласно закону сохранения заряда  $q_1 + q_2 = \text{const}$ .

$$C_1U + C_2U = CU$$

$$C_1 + C_2 = C$$

$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

## Энергия заряженного проводника

В поле уединенного проводника перемещаем заряд  $dq$ .

При переносе заряда  $dq$  из  $\infty$  на проводник емкостью  $C$  имеющий потенциал  $\varphi$ , совершается работа:

$$dA = \varphi \cdot dq$$

$$\varphi = \frac{q}{C}$$



$$dA = \frac{q dq}{C}$$

При этом заряд проводника увеличивается на  $dq$ .

## Энергия заряженного проводника

Работа, затрачиваемая на зарядку проводника от нулевого потенциала ( $\varphi = 0$ ) до  $\varphi$

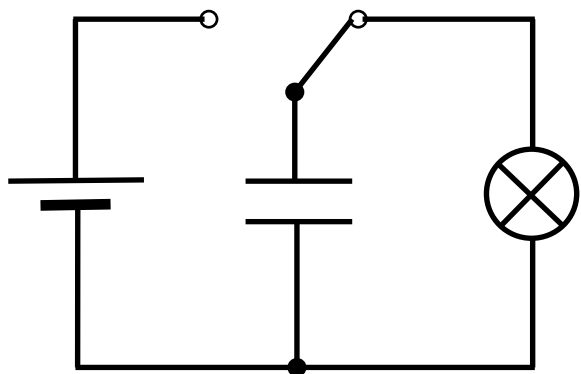
$$A = \int dA = \int \frac{q dq}{C} = \frac{q^2}{2C}$$

Энергия заряженного проводника равна работе, которую необходимо совершить, чтобы зарядить этот проводник:

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\varphi^2}{2}$$



## Энергия заряженного конденсатора



Если заряженный конденсатор замкнуть на электрическую лампочку, то она какое-то время будет гореть.

Следовательно, конденсатор обладает энергией.

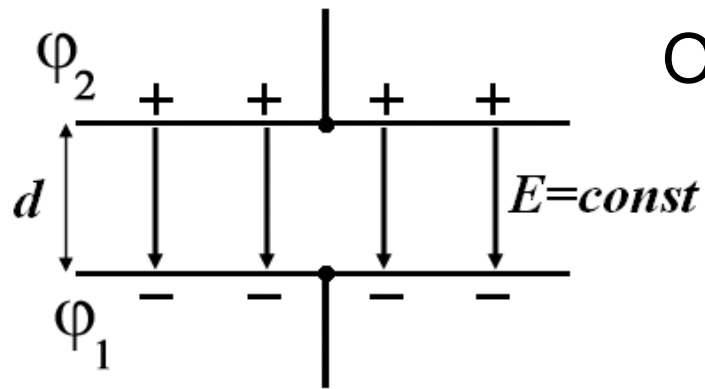
$$\left. \begin{aligned} dA &= U \cdot dq \\ U &= \frac{q}{C} \end{aligned} \right\}$$



$$dA = \frac{q dq}{C}$$

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2}$$

## Объемная плотность энергии электрического поля



Объемная плотность энергии:

$$\omega = \frac{W}{V} = \frac{CU^2}{2Sd}$$

$$\omega = \frac{C(Ed)^2}{2Sd} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S(Ed)^2}{d \cdot 2Sd}$$

$$\omega = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{ED}{2}$$

- энергия, приходящаяся на  
единичный объем однородного поля.

$$dW = \omega \cdot dV \quad W = \int_V \omega \cdot dV$$